

الباب الحادى عشر

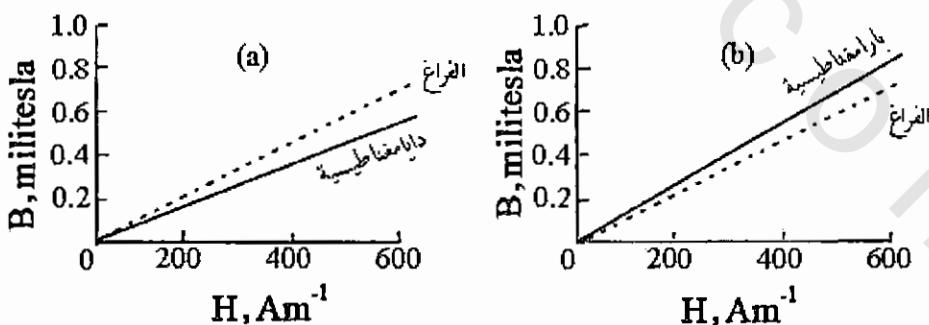
الخواص المغناطيسية للمواد الصلبة Magnetic properties of solids

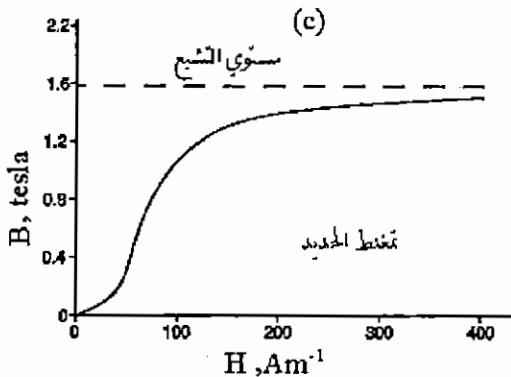
المجال المغناطيسي في المواد الصلبة

منحنى التمغناطيسية Magnetization curves

عادة يكون مرغوباً أن نبدأ بالعلاقة $H-B$ بين كثافة الفيض B وشدة المجال H المعروفة بمنحنى التمغناطيسية كمدخل لدراسة الخصائص المغناطيسية للمواد. شكل (11-1) يبيّن أن هذه العلاقة لكل المواد الديا - والبارامغناطيسية عبارة عن خط مستقيم ميله يتغيّر من القيمة $4\pi \times 10^{-7}$ التي تمثل النفاذية المغناطيسية للفراغ μ_0 إلى قيم أصغر (شكل a. 11-1) أو أكبر (شكل b. 11-1) في حالة الديا - أو البارامغناطيسية على الترتيب، وبالتالي يكون نمو الفيض مع المجال أبطأ بشكل طفيف من حالة الفراغ في حالة الديا المغناطيسية وأسرع بشكل طفيف في حالة المواد البارامغناطيسية.

أما في حالة المواد الفيرو - مغناطيسية كالحديد (شكل c. 11-1)، فإن منحنى التمغناطيسية هو منحنى فعلٍ وليس خطًا مستقيماً، وأجزاءه تعكس مراحل التمغناطيسية المختلفة للمواد الفيرو - مغناطيسية، كما أن كثافة الفيض كبيرة، حيث تقاوم بالتسلا وليس بالمللى تسلا كما هو الحال للمواد غير الفيرو - مغناطيسية.





شكل: (11-1) مذكى التمغناط H-B للمواد الديامغناطيسية (a)
والبارامغناطيسية (b) والفيرومغناطيسية (c).

المواد المغناطيسية وكيفية تمغناطها

نتيجة حركة الإلكترونات المدارية orbital والمغزليه spin تنشأ العزوم المغناطيسية وتتمغناط المواد. وتعتمد قيمة العزم ونوع تمغناط المادة على ما إذا كانت الإلكترونات الذرة أو الآيون متزاوجة paired (زوج من الإلكترونات متضاداً للحركة المغزليه) أوغير متزاوجة unpaired. والحركة المغزليه تجعل الإلكترونات تمتلك عزماً مغناطيسياً مغزلياً يتوجه مع أو ضد المجال المغناطيسي المطبق عندما يكون العدد الكمي المغزلي m_s مساواً $\frac{1}{2} +$ أو $\frac{1}{2} -$ على الترتيب. ويكون للذرة التي تحتوي على عدد متزاوج من الإلكترونات مشاركة مغزليه $S \approx 0$ لأن مشاركة الإلكترونات المتزاوجة تلغى بعضها بعضها. أما إذا كانت المادة تحتوى على أعداد غير زوجية من الإلكترونات، فإن $0 < S$. وبناه على هذا المفهوم يمكن تقسيم المواد كالتالى:

مواد دايامغناطيسية Diamagnetics

ذرة الهيدروجين عبارة عن نواة ذات بروتون مستقر موجب الشحنة يدور حوله إلكترون سالب. هذا الإلكترون في مداره يمثل حلقة تيار current loop، لذا، فقد نتصور أن غاز الهيدروجين يمتلك عزماً مغناطيسياً قوياً. وفي الواقع، يمتلك غاز الهيدروجين مغناطيسية ضعيفة جداً، وذلك لأن ذرة الهيدروجين لا تكون منفصلة ولكنها تفضل الارتباط مع ذرة أخرى في صورة جزيء حيث تكون طاقتها الكيميائية

فى هذه الحالة أقل. وفى هذا الجزء، كمية الحركة الزاوية لأحد الإلكترونات تكون مضادة للآخر، مما يجعل العزم المغناطيسي للجزء ككل صغيرا جداً أو مساوياً للصفر. هذا التصرف صحيح للعديد من المواد التي تتميز بافتقارها إلى العزم المغناطيسي الدائم. وإذا وضع مثل هذا الجزء في مجال مغناطيسي فإن المجال الحثى يؤثر بقوة على الإلكترون فيغير من كمية حركته بشكل طفيف، ويصبح للجزء عزم مغناطيسي حتى اتجاهه عكس اتجاه المجال المغناطيسي المطبق، وهي خاصية المواد الديامغناطيسية. عموماً، فالمواد الديامغناطيسية هي تلك المواد التي تملك الإلكترونات زوجية وتمنعها من التغير الطفيف في كمية الحركة الدارية للإلكترونات. ومن أمثلتها الهيدروجين، الأمونيا، البزموت، النحاس، الجرافيت. هذه المواد تتنافر مع المجال المغناطيسي بشكل ضعيف بسبب ضعف المجال المغناطيسي الحثى المعاكس الناتج من دوران الإلكترونات.

مواد بارامغناطيسية Paramagnetics

في الجزيئات ذات الإلكترونات غير التزاوجية (الأكسجين مثلاً) تكون عملية الإلغاء cancellation للعزم المغناطيسي غير كاملة، ويكون للجزء O_2 عزماً مغناطيسياً دائماً، حتى في عدم وجود مجال خارجي. فإذا طبق مجال مغناطيسي فإن المدارات الإلكترونية تتغير كما في حالة الديامغناطيسية، ولكن العزم المغناطيسي الدائم لها يكون عادةً أقوى تأثيراً، وتتوجه أقطاب الجزيئات في خط مواز للمجال المغناطيسي وتنقليه. مثل هذه الجزيئات تسمى بaramغناطيسيات.

والمواد البارامغناطيسية مثل الأكسجين، القصدير، الألومنيوم، كبريتيد النحاس تنجذب نحو المغناطيس. وهذا التأثير ضعيف أيضاً مثل حالة المواد الديامغناطيسية، وذلك لأن العزوم الدائمة تخمد وتتباطئ اتجاهاتها بسبب مجال الاهتزازات الحرارية حتى في درجة حرارة الغرفة، فقط يمكن للأكسجين السائل ($-183^{\circ}C$) أن ينجذب إلى المغناطيس القوى.

ورغم أن المواد الديا - والبارامغناطيسية لا تملك أهمية تكنولوجية، إلا أنها الأكثر دراسة بواسطة الفيزيائيين.

مواد فيرومغناطيسية Ferromagnetic

تعتبر المواد الفيرومغناطيسية مثل عناصر أو مركبات الحديد، النيكل، الكوبالت،

المنجنيز أهم أنواع المواد المغناطيسية. منحنى التمغnet H-B لهذه المواد يختلف عنه بشدة للمواد الدايريا - والبارامغناطيسية ، ويعتمد بقوة على درجة النقاء purity، المعالجة الحرارية وعلى عوامل أخرى.

وعلى المستوى الذري، يمكن تفسير الفيرومغناطيسية بمبدأ العزوم الذري التجاورة للتوجه بموازاة بعضها بعضاً، الأمر الذي لا يحدث إلا عند درجات حرارة أقل من درجة حرارة معينة لكل مادة تسمى نقطة كوري، حيث فوقها يحدث هبوط حاد في النقادية المغناطيسية بسبب التأثير الحراري الذي يعمل على تشتيت العزوم المترتبة وانحلال الفيرومغناطيسية إلى بارامغناطيسية. وتتميز الفيرومغناطيسية عن البارامغناطيسية بالقيم الأكبر للنقادية وكذلك لخصائصها الهامة من حيث التخلف أو الباقى المغناطيسى coercivity remnance .

مواد فيرمغناطيسية (فيرايتس Ferrites)

هذا النوع من المواد المغناطيسية يكاد يشارك في صناعة كل الأجهزة الإلكترونية التي تنتج حالياً، فالسماعات، الموتورات، الدعامات الحارفة deflection yokes، قوامع التداخل الموجى interference suppressors، ساق الإريال أو الهوائي antenna rods، الكواشف proximity sensors، رؤوس المسجلات recording heads، المحولات transformers، المحاثات inductors الخ كل منها يحتوى على مادة فيرمغناطيسية معينة. هذه الشمولية التكنولوجية للمواد الفيريمغناطيسية ترجع إلى خصائصها الهامة التالية:

- أ- نقاديتها المغناطيسية العالية التي جعلتها تمييز على معظم المواد الفيرومغناطيسية.
 - ب- صغر فقد الطاقة في التيارات الدوامية لكبر مقاومتها النوعية.
 - ج- سهولة تصنيعها في أشكال مختلفة بتكنولوجيات قليلة التكاليف.
- وت تكون المواد الفيريمغناطيسية من أكسيد الحديد متعددة مع واحد أو أكثر من المعادن الانتقالية مثل المنجنيز، النيكل أو الزنك على غرار المركب $MnFe_2O_4$ ، حيث تؤخذ المواد الخام وتسحق على هيئة مسحوق ثم تصهر أو تلبد حراريا sintered ل الحصول على مادة خزفية ذات لون رمادي داكن، قاسية، هشة لها تركيب بلوري مكعبى.

وتعتمد الخواص المغناطيسية الذرية لهذه المواد على تفاعل الإلكترونات المرتبطة بأيونات المعادن، وترتبط العزوم المغناطيسية الذرية التجاورة بحيث تكون متضادة

الاتجاه مع بعضها البعض (عكس المواد الفيرومغناطيسية)، ولما كانت العزوم في أحد الاتجاهين أضعف منها في الاتجاه المعاكس، فإن المادة يكون لها عزم مغناطيسي محصل دائم.

التشبع المغناطيسي saturation

التشبع المغناطيسي هو الحد الأقصى للتمغnet أو الحث في المواد التي تحتوى على قلب فيرو- أو فيريمغناطيسي. بداية، عند زيادة التيار يزداد الفيض طردياً معه، وأى زيادات إضافية بعد نقطة معينة تؤدى إلى زيادات صغيرة في الفيض، وبعد ذلك لا يقدم القلب أى مساهمات في نمو الفيض، الذي يصبح محدوداً فقط بمساهمة الفراغ، وهي في حدود ثلات رتب أقل. ومن المعلوم أن الحديد يتسبّب عند تسلا تقريباً، بينما تتسبّب المواد الفيريايت بين 200، 500 ملي تسلا. وفي التطبيقات عادة نتحاشى الوصول لمرحلة التشبع لأنها تكون مصحوبة بهبوط حاد في قيمة الحث، ففي العديد من الدوائر الإلكترونية يتتناسب معدل زيادة التيار في الملف عكسياً مع معامل الحث. لذلك، أى هبوط في الحث يسبب زيادة سريعة في التيار تؤدى إلى زيادة شدة المجال للدرجة التي تحطم قلب الملف.

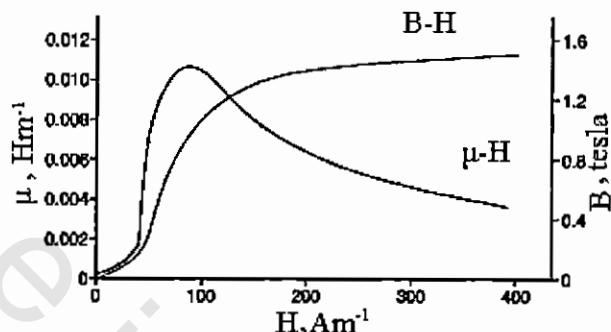
النفاذية المغناطيسية Permeability

النفاذية المغناطيسية المطلقة

يمكننا تخيل أن النفاذية المغناطيسية قريبة الشبه بالوصلية الكهربية، ذلك لأن المادة ذات الوصلية الكهربية العالية تسمح بمرور التيار خلالها بشكل أسهل من غيرها، وبالمثل المادة التي تمتلك نفاذية عالية يمكنها أن تمرر الفيض المغناطيسي بسهولة خلالها. ولما كانت المواد الفيرومغناطيسية تتميز بالنفاذية المغناطيسية العالية، لذلك يستخدم الحديد في صناعة قلب الملف للحصول على حث كبير، حيث يتتناسب الحث طردياً مع النفاذية المغناطيسية μ ، تماماً كما يتتناسب التيار مع الوصلية الكهربية σ . وعلى غرار تعريف الوصلية الكهربية بأنها النسبة بين كثافة التيار وشدة المجال الكهربى، تعرف النفاذية المغناطيسية ل المادة ما بأنها النسبة بين كثافة الفيض وشدة المجال المغناطيسي.

$$\text{i.e. } \mu = \frac{B}{H} \quad (11 - 1)$$

ووحدتها هنري / م (Hm⁻¹)



شكل (11-2): النفاذية المغناطيسية المشتقة من منحنى التمغnet للحديد

إذا كان التغير في كثافة الفيض غير منتظم مع تغير شدة المجال، فإنه يمكن التعبير عن النفاذية المغناطيسية بما يسمى النفاذية التفاضلية μ ، حيث:

$$\mu = \frac{dB}{dH}$$

شكل (2-11) يعطي النفاذية المغناطيسية المشتقة من المنحنى H-H، نلاحظ أن النفاذية لا تكون متساوية لميل الماس للمنحنى ما عدا عند القمة (حول القيمة).

النفاذية المغناطيسية للفراغ μ_0

لها نفس الوحدة للنفاذية المغناطيسية المطلقة (Hm⁻¹)، ولها قيمة محددة تساوى $4\pi \times 10^{-7}$ Hm⁻¹، وهى قيمة ثابتة لا تعتمد على شدة المجال أو درجة الحرارة، خلافاً للنفاذية المطلقة للمواد الفيرو-مغناطيسية التي تعتمد بشدة على كل من درجة الحرارة وشدة المجال. ومعظم المواد غير-الفيرو-مغناطيسية مثل الخشب، البلاستيك، الزجاج، النحاس، الطعام (العاج)، الهواء والماء لها نفاذية تساوى تقريباً نفاذية الفراغ، وبالتالي تكون نفاذيتها النسبية متساوية 1.0.

النفاذية المغناطيسية النسبية (μ_r)

تعتبر الأكثر استخداماً في التواحي الهندسية وهي النسبة بين القيمة المطلقة μ إلى نفاذية الفراغ μ_0 ، أى أن:

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0} = \frac{B}{B_0} \quad (11 - 2)$$

وبالتالي فهى كمية بدون أبعاد. حيث B_0 هى كثافة الفيصل فى الفراغ. ورغم أن μ_0 تتناسب طرديا مع μ ، إلا أنها تعبر بشكل أوضح عن مدى تأثير المادة على العلاقة بين كثافة الفيصل وشدة المجال، فمثلا إذا كان للمادة $\mu_r = 3$ ، فإن هذا يبين لنا أن كثافة الفيصل ثلاث مرات أكبر منها للفراغ، وهذا أكثر وضوحا من القول إن $\mu = 3.77 \times 10^6 \text{ Hm}^{-1}$.

ويستخدم عادة مصطلح النفاذية الأولية initial permeability (μ_i) ليصف النفاذية النسبية للمادة عند قيم صغيرة لكثافة الفيصل (أقل من 0.1 تسلا). والقياسات عند قيم منخفضة للفيصل تكون أكثر أمانا عنها لحالة التشبع المغناطيسي.

النفاذية الفعالة μ_{eff}

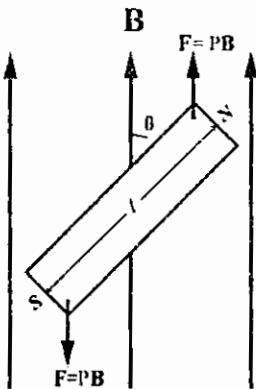
يستخدم هذا المصطلح عادة بدلا من النفاذية النسبية في حالة المواد التي تحتوى على فجوات هوائية air gaps مثل الملفات، قلوب المحولات، الخ.

العزم المغناطيسي magnetic moment

مفهوم العزم المغناطيسي يعتبر نقطة البداية عند دراسة تصرف المواد المغناطيسية في المجال المغناطيسي. فإذا وضعت قضيبا مغناطيسيا في مجال مغناطيسي، فإنه يتأثر بعزم ازدوج τ (أوعزم moment) يحاول توجيهه في اتجاه المجال (شكل)، وهو ما يحدث لإبرة البوصلة. هذا الإزدوج يزداد بزيادة كل من شدة المجال، شدة القطب P والمسافة بين القطبيين l ، وتعطى قيمته كالتالي:

$$\tau = PBl \sin \theta$$

ووحدته هي نيوتن. م (وهي وحدة طاقة). ويعرف العزم المغناطيسي M بأنه قيمة عزم الإزدوج المؤثر على المغناطيس عندما يكون عموديا على مجال كثافة فيضة الوحدة. i.e $M = Pl$



شكل (11 - 3): عزم الازدواج المؤثر
على القضيب المغناطيسي

والمغناطيس عندما لا يكون موازياً للمجال يكون له طاقة وضع U بالنسبة لوضع التوازي. والشغل المبذول ضد المجال لإدارة المغناطيس بزاوية $d\theta$ يعطى كالتالي:

$$dU = MB \sin \theta d\theta$$

والشغل المبذول لدوران المغناطيس من وضع التعامد ($\theta = 90^\circ$) إلى وضع التوازي ($\theta = 0^\circ$) مع المجال يكون هو:

$$U = \int_0^{90} MB \sin \theta d\theta = -MB \cos \theta \\ = M \cdot B \quad (11 - 3)$$

كذلك نعلم أن الحلقة التي يمر بها تيار i في مجال مغناطيسي كثافته B تتأثر أيضاً بعزم ازدواج τ (كما يحدث في المотор) بزيادة كل من التيار ومساحة الحلقة A ، فإذا كانت الزاوية بين محور الحلقة (العمودي على مستواها) واتجاه المجال المغناطيسي هي θ ، فإن:

$$\tau = BiA \sin \theta$$

والكمية ixA تعرف بالعزم المغناطيسي M .

$$i.e \tau = BiA \sin \theta$$

ولما كان العزم المغناطيسي كمية متوجهة لها قيمة واتجاه، لذلك فرغم أن الذرات في معظم المواد لها قيمة للعزم المغناطيسي، فإنه ليس سهلاً توجيهها في اتجاه واحد، وقد يؤدي ذلك إلى أن تلغى العزوم بعضها بعضاً، مما يؤدي إلى مغناطيسية ضعيفة. الأرض تملك عزماً مغناطيسياً قيمته $8 \times 10^{22} \text{ Am}^2$. والإلكترون المفرد يملك عزماً مغناطيسياً بسبب مداره حول النواة يساوي مضاعفات القيمة $9.27 \times 10^{-24} \text{ Am}^2$ التي تعرف بوحدة العزوم المغناطيسية أو بوهر ماجنتون μ_B .

نستنتج من ذلك أن أساس المغناطيسية هو إما قطبان مختلفان، أو دورة تيار current circulation.

التمغنتية أو درجة التمagnetization

ينشأ المجال المغناطيسي بسبب حركة الشحنات (الإلكترونات)، فالسلك الذي يحمل تياراً (شحنات متحركة) ينتج مجالاً مغناطيسياً في محيطه. كذلك، المجال المغناطيسي الناشئ عن الأقطاب المغناطيسية هو أيضاً ناشئ عن حركة الشحنات: حركة الإلكترونات في مدارات حول الأنوية وحركتها المغزالية حول محاورها، مثل هذه الذرات يقال إنها تمتلك عزماً مغناطيسياً. شدة المجال المتوسط لهذه العزوم (العزم المغناطيسي لوحدة الحجم) عند أي نقطة يسمى التمغنتية ويعبر عن درجة تمغنت الماد. في معظم المواد يكون اتجاهات هذه العزوم عشوائية، وبالتالي تكون التمغنتية ضعيفة ولا تظهر الخواص المغناطيسية لها. وفي مواد أخرى مثل الحديد توجه العزوم نفسها في اتجاه المجال الخارجي المطبق ويكون لها تمغنتية كبيرة وتظهر الخصائص المغناطيسية بوضوح.

والآن، إذا وضع جسم متجانس حجمه V في مجال مغناطيسي منتظم شدته H فإنه يصبح ممغنطاً ويكون له عزم مغناطيسي M ، وتعطى التمغنتية J_m كالتالي:

$$J_m = \frac{M}{V} \quad (11 - 4)$$

فإذا كان التمغنت غير منتظم فإنه يمكن التعبير عن التمغنتية بالعلاقة الآتية:

$$J_m = \frac{dM}{dV} \quad (11 - 5)$$

والمغنتية كمية متوجة لأنها إما أن تكون في اتجاه المجال أو ضدّه. ولما كانت وحدة العزم المغناطيسي M في النظام SI هي Amp.m^2 ، فإن وحدة التمغنتية تكون Amp/m .

القابلية المغناطيسية Susceptibility

على غرار السماحية الكهربية $\chi_e = \epsilon - 1$ فإن القابلية المغناطيسية تعطى بالعلاقة الآتية:

$$\chi = \mu r - 1$$

(11 - 6)

وستستخدم أيضاً المصطلحات التالية للقابلية المغناطيسية:

- القابلية المغناطيسية الكتليلية، حيث:

$$\chi_p = \frac{\chi_v}{\rho}, \text{ m}^3 \text{Kg}^{-1} \quad (11 - 7)$$

- القابلية المغناطيسية المولارية، حيث:

$$\chi_m = \frac{\chi_v W_a}{\rho}, \text{ m}^3 \text{mol}^{-1} \quad (11 - 8)$$

حيث ρ هي كثافة المادة بالكيلوجرام/م³، W_a هي الكتلة المولارية molar mass بالكيلوجرام / مول.

وتعرف القابلية المغناطيسية χ بأنها النسبة بين التمغنتية للمادة والمجال المغناطيسيي المسبب لها (أو هي التمغنت الحادث في المادة بسبب تأثير مجال شدته الوحدة).

$$i.e \quad \chi = \frac{J_m}{H} \quad (11 - 9)$$

وهي كمية بدون أبعاد لأن H & J_m لهما نفس الأبعاد، ويطلق عليها عادة القابلية الحجمية Bulk or volumetric ويرمز لها بالرمز χ . والمواد المغناطيسية منتظمة التمغنت Isotropic magnetic materials ينشأ عنها مجال مغناطيسي منتظم خارج حدودها اتجاهه مع أو ضد اتجاه المجال الخارجي. والكثافة الكلية B للفيض المغناطيسي عند نقطة تعطى بالمجموع الجيرى لكثافتي الفيض B_0 ، B_1 الناتجين عن المجال الخارجى والمجال الناشئ عن تمغنت المادة على الترتيب، أى أن:

$$B = B_0 + B_1 = B_0 + Im \quad (11 - 10)$$

حيث Im تعرف بشدة التمغنت، وهى كثافة الفيض المغناطيسي المتولد بواسطة المادة نتيجة تمغنطها، وترتبط مع التمغنتية بالعلاقة الآتية:

$$Im = \mu_0 J_m \quad (11 - 11)$$

وتقاس بالتسلا (وبير/م²).

$$\therefore B_0 = \mu_0 H, \quad B_1 = Im = \mu_0 J_m$$

$$\therefore B = \mu_0 (H + J_m) \quad (11 - 12)$$

وهذه المعادلة ذات دلالة خاصة لأنها تربط بوضوح بين شدة المجال H الذى ينتج عن الشحنات الحرة (المنسابة من بطارية عبر قطعة من سلك مثلاً)، والتمغنتية J_m التى تنتج عن التيارات الداخلية فى المدرات الإلكترونية خلال المادة. وبالتعويض عن $J_m = \chi H$ فى العلاقة الأخيرة، نجد أن:

$$B = (1 + \chi) B_0 = \mu_r B_0 = \mu_r \mu_0 H \quad (11 - 13)$$

وطبقاً لإشارة القابلية المغناطيسية وقيمتها يمكن أيضاً تقسيم المواد إلى ثلاث مجموعات أساسية هي: مواد دايامغناطيسية، مواد بارا مغناطيسية، مواد فيرومغناطيسية كما يبين جدول (11-1). تتميز المواد الدايامغناطيسية بأن لها إشارتها سالبة، ولا تعتمد على المجال المغناطيسي الخارجي أو على درجة الحرارة. وتتميز المواد البارامغناطيسية بأن لها $\chi > 1$ وإشارتها موجبة، ولذلك فهي تتغير في اتجاه المجال الخارجي.

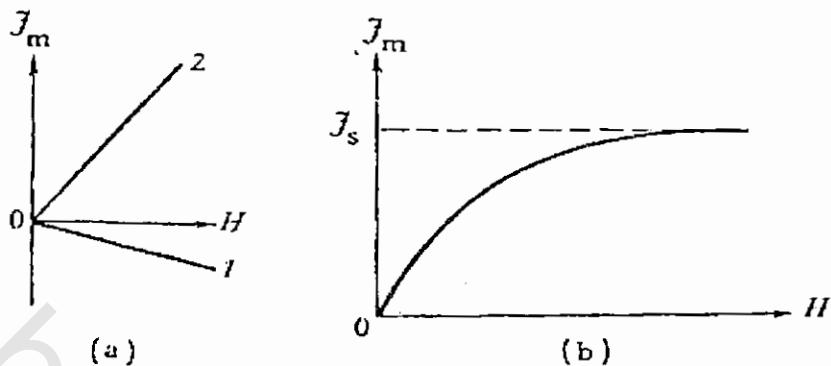
جدول (11-1): القابلية المغناطيسية لبعض المواد.

مواد دايامغناطيسية $\chi = \mu_r - 1$	مواد بارا مغناطيسية $\chi = \mu_r - 1$	مواد فيرمغناطيسية $\chi = \mu_r - 1$
Bi - 18×10^{-5}	CaO 580×10^{-5}	Fe 1000
Cu - 0.9×10^{-5}	FeCl ₂ 360×10^{-5}	Co 240
Ge - 0.8×10^{-5}	NiSO ₄ 120×10^{-5}	Ni 150
Si - 0.3×10^{-5}	Pt 26×10^{-5}	

ولدراسة تغير القابلية المغناطيسية للمادة مع شدة المجال يستخدم عادة منحنى التمagnetization curve. شكل (11-4.a) يعطي هذا المنحنى للمواد الدايامغناطيسية (منحنى 1) وللمواد البارامغناطيسية (منحنى 2). في كلتا الحالتين تتناسب طردياً مع H، وهذا يفسر عدم اعتماد χ على شدة المجال H. ويستثنى من ذلك المواد البارامغناطيسية في حالة المجالات القوية أو عند درجات الحرارة المنخفضة، حيث نلاحظ أن تقترب تدريجياً من قيمة التشبع المغناطيسي J_s magnetic saturation مع زيادة قيمة المجال H (شكل 11-4.b)، مما يعني أن χ تتغير مع تغير شدة المجال، وهو ما أكدته بيير كوري Pierre Curie، حيث بين أن القابلية المغناطيسية تتناسب عكسياً مع درجة الحرارة.

$$i.e. \chi = \frac{C}{T} \quad (11 - 14)$$

حيث T هي درجة الحرارة المطلقة للمادة البارامغناطيسية، C ثابت يعتمد على طبيعة هذه المادة ويسمي ثابت كوري (Curie constant)، وتعرف هذه العلاقة بقانون كوري (Curie law).

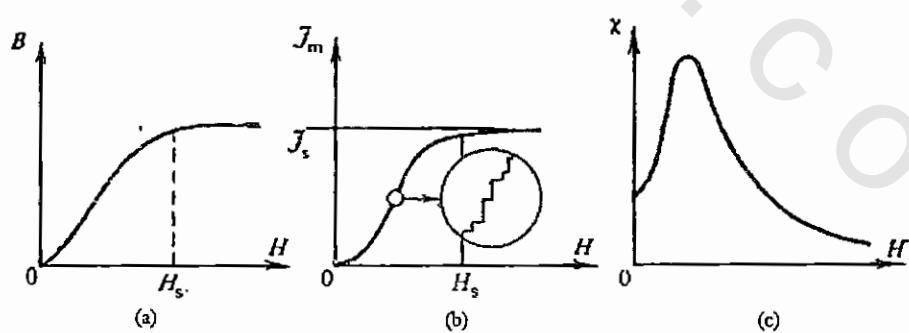


شكل (4-11): منحنى التمغnet للمواد الديا والمغناطيسي (a) وللمواد البارامغناطيسي
في المجالات القوية أو درجات الحرارة المنخفضة (b).

وفي حالة المواد الفيرومغناطيسية تكون إشارة χ موجبة، وقيمتها أكبر بكثير منها
للمواد البارامغناطيسية، كما أنها تعتمد على شدة المجال H .

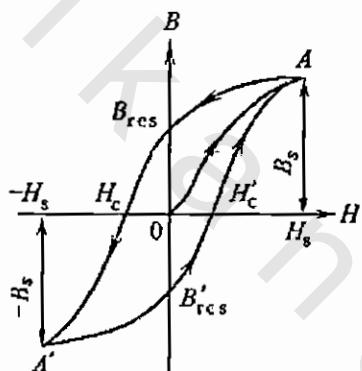
التخلوف المغناطيسي في المواد الفيرومغناطيسية

شكل (5-11) يبين العلاقة بين كل من B ، J_m ، χ مع شدة المجال المغناطيسي H
للحديد المطاوع. نلاحظ أن كلاً من J_m ، B ، تزيد مع زيادة شدة المجال حتى تصل
المادة لحالة التشبع المغناطيسي، ومع الاقتراب من حالة التشبع تقترب χ من الصفر
(شكل 5-5). والدراسة المتأنية لنحنى التمغnet تبين أنه مع زيادة H فإن J_m لا تزداد
بشكل متصل، بل تحدث الزيادة على قفزات (شكل b)، وهو ما اكتشفه هيذرش
باراهوسن وأصبح هذا التأثير معروفاً بتأثير باراهوسن (Barakhausen effect).



شكل (5-11): تغير كل من B ، J_m ، χ مع شدة المجال المغناطيسي للحديد المطاوع

شكل (11-6) يعطى دورة كاملة لعملية التمغnet، حيث يتضح أنه في أثناء عملية المغnetة في الاتجاه المضاد فإن B تختلف عن H ، وعندما $H = 0$ تكون $B = B_{res}$. هذا التخلف في قيمة B يسمى التخلف المغناطيسي magnetic hysteresis، ويسمى الحث B_{res} بالحث المغناطيسي المتبقى (المتخلف) residual magnetic induction، الحد H_c AA' بالحد المغناطيسي المغلق Coercive force. المنحنى المغلق AA' يسمى دورة التخلف المغناطيسي Hysteresis loop. ومساحة هذه الدورة تتناسب طردياً مع الشغل المبذول في مغnetة وحدة الحجم من المادة. ومع تكرار التمغnet فإن الشغل يتحول كلياً إلى حرارة، لذلك عندما تعاد مغnetة مادة فيرمونغناطيسية عدة مرات نلاحظ ارتفاع درجة حرارتها، وكلما كانت مساحة دورة التخلف كبيرة كان هذا التأثير كبيراً.



شكل (11-6): التخلف المغناطيسي
في المواد الفيرومغناطيسية

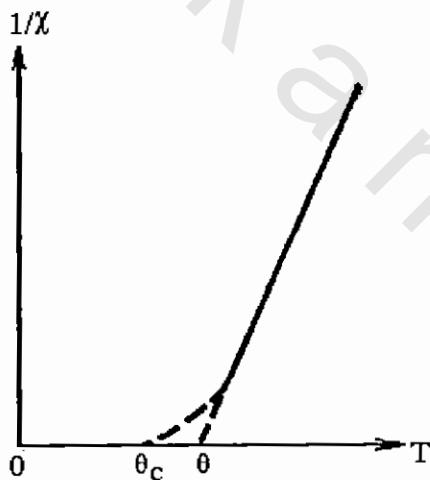
وتصنف المواد الفيرومغناطيسية إلى مواد لينة Soft كالحديد المطاوع، ومواد قاسية hard تتميز بقوة ممانعة عالية Coercive force كالحديد الصلب. وتستخدم المواد اللينة في صناعة قلب المotor الكهربائي والأجهزة التي تحتاج لقوة ممانعة مغناطيسية صغيرة ونفاذية كبيرة. وحتى وقتنا هذا فإن أفضل سبائك هذا النوع هي سبيكة السوبريم التي لها قيمة كبيرة للنفاذية ($\mu = 10^5$) وقيمة قصوى للحث (قيمة التشبع) في حدود $B = 1$ Tesla وقوة ممانعة مغناطيسية $H_c = 0.32$ A/m ومساحة دورة التخلف المغناطيسي لها حوالي 500 مرة أقل منها للحديد المطاوع. وتستخدم المواد القاسية في صناعة المغناطيسات الثابتة، وذلك لأنها تتميز بقوة ممانعة مغناطيسية عالية وتختلف مغناطيسياً على، وتعتبر سبيكة الماجنيكو من أفضل سبائك هذا النوع حيث لها $H_c = 5 \times 10^5$ A/m.

$$B_{res} = 1.35 \text{ T}$$

عندما تسخن المواد الفيرومغناطيسية فإن خواصها المغناطيسية تصبح أقل وضوحا، حيث يحدث نقص كبير في قيمة χ_m ... الخ، وتفقد صفاتها الفيرومغناطيسية عند درجة حرارة θ_C تعرف بدرجة حرارة أو نقطة كوري (curie point)، حيث تبلغ 1150، 360 & 770 درجة سيلزيوس للكوبالت، الحديد والنحاس على الترتيب. وعند درجة حرارة أعلى من نقطة كوري فإنها تتحول إلى مادة بارامغناطيسية، حيث تتناسب χ عكسياً مع درجة الحرارة (شكل 11-7) طبقاً لقانون كوري- وايس (Curie- Weiss law) الآتي :

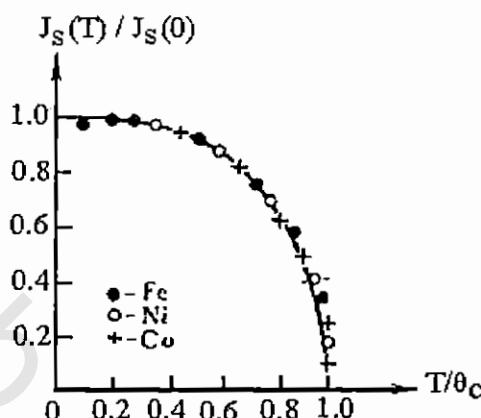
$$\chi = \frac{C}{T - \theta} \quad (11 - 15)$$

حيث C ثابت كوري، θ نقطة كوري- وايس البارامغناطيسية (وهي أعلى بعض الشيء من θ_C).



شكل (11-7): تغير القابلية المغناطيسية مع درجة الحرارة وتحول المادة الفيرومغناطيسية إلى بارامغناطيسية بعد نقطة كوري

شكل (11-8) يعطى منحنى الاعتماد الحراري للقيمة القصوى للتمغنت في حالات الحديد، النحاس، الكوبالت، والنحاس الذي يمكن الحصول عليه برسم العلاقة بين النسبة $\frac{J_s(T)}{J_s(0)}$ على المحور الرأسى والنسبة $\frac{T}{\theta_C}$ على المحور الأفقي. وهو يمثل منحنينا عاماً يصف كل المواد الفيرومغناطيسية. واضح أنه كلما زادت درجة الحرارة تقل التمغنتية J وتتصبح علية مساوية للصفر عند نقطة كوري ($T = \theta_C$).



شكل (11-8): المنحنى العام للاعتماد الحراري لمغнет الماء الفيرومغناطيسيية

جدول (2-11) يعطي ملخصاً لبعض خصائص المواد المغناطيسية.

جدول (2-11) : بعض خصائص المواد المغناطيسية.

قيمة χ	مثال	يحدث تخلف مغناطيسي	χ تعتمد على T	χ تعتمد على B	نوع المادة
-9×10^{-6}	الزنك	لا	لا	لا	دايامغناطيسية
2.2×10^{-5}	الألومنيوم	لا	نعم	لا	بارامغناطيسية
3000	الحديد	نعم	نعم	نعم	فيرومغناطيسية
-9.51×10^{-6}	تريبيوم	نعم	نعم	نعم	أنثيرومغناطيسية
2500	$Mn_{72}Fe_{20}O_4$	نعم	نعم	نعم	فيريمغناطيسية

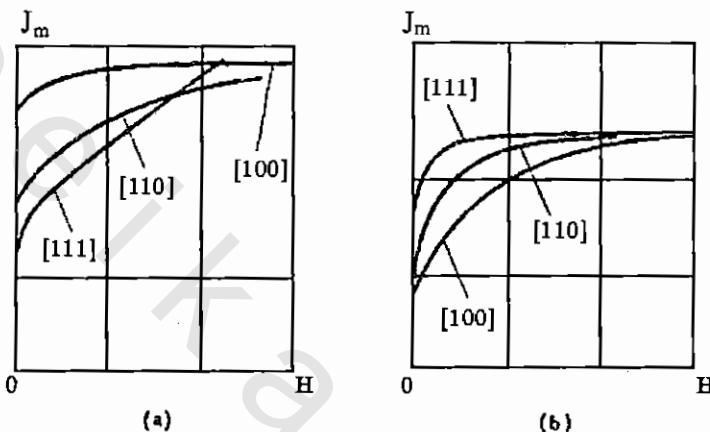
اتجاهات التمغnet في البليورات الفيرومغناطيسية

البليورات الأحادية single crystals للمواد الفيرومغناطيسية تتميز بأنها غير متتجانسة الخواص المغناطيسية anisotropic، حيث يكون التمغnet والوصول إلى التشبع المغناطيسي سهلاً في بعض الاتجاهات وصعباً في اتجاهات أخرى. فكما نلاحظ من منحنينات التمغnet (شكل 9-11) لبليورات الحديد (a) والنيكل (b) في الاتجاهات [111] & [100]، [100] أن التمغnet والوصول إلى حالة التشبع المغناطيسي يكون ممكناً باستخدام قيم صغيرة نسبياً لشدة المجال المغناطيسي في الاتجاه [100] للحديد وفي الاتجاه [111] للنيكل، ويكون أكثر صعوبة في الاتجاهات [110] & [111] للحديد

وفي الاتجاهات [110] & [100] للنيكل، حيث نحتاج إلى مجال شدته أكبر لنصل إلى حالة التشبع المغناطيسي. ويتحدد الشغل المبذول W_m في عملية التمغنط في اتجاه ما بالتكامل على منحنى التمغنط ويعطى كالتالي:

$$W_m = \int_0^{J_m} \mu_0 H dJ_m \quad (11 - 16)$$

هذا الشغل يتحول إلى طاقة حرارة للبللورة، وأقل قيمة له تكون في اتجاه التمغنط السهل.

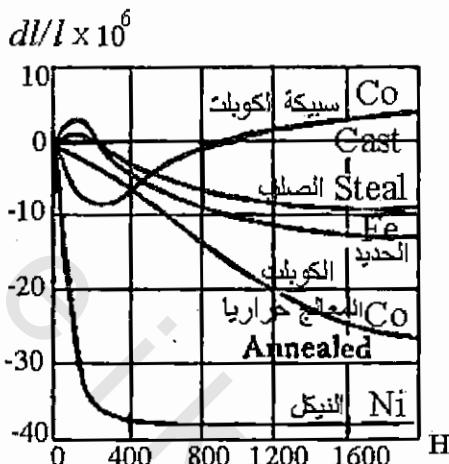


شكل (11-9): إتجاهات التمغنط في البللورات الفيرو-مغناطيسية

تأثير التمغنط على أبعاد المادة الفيرو-مغناطيسية

للحظ أنه عندما تتمغنط المواد الفيرو-مغناطيسية تتغير أبعادها وشكلها، هذه الظاهرة سميت بالانفعال المغناطيسي. Magnetostriiction شكل (10-11) يبين التغير النسبي في أطوال بعض العينات المصنوعة من النيكل، سبيكة الكوبالت، الكوبيلت المعالج حرارياً، الحديد والصلب بعد وضعها في مجال تزداد شدته تدريجياً. نلاحظ أن أكبر نقص نسبي يحدث في عينة النيكل ويساوي تقريرياً 0.004%， وأن ساقى الحديد والصلب يزداد طولهما في المجالات الضعيفة وينقصان في المجالات القوية. وعلى النقيض من ذلك، فإن سبيكة الكوبيلت تنقص في الطول في المجالات الضعيفة، بينما يزداد طولها في المجالات القوية. ويمكن تفسير ذلك طبقاً لمبدأ لي شاتيليه الذي ينص على أن «النظام يقاوم تأثير العوامل الخارجية التي تعمل على تغيير حالته»، لذا فإن الانفعال الميكانيكي الحادث في الأجسام الفيرو-مغناطيسية، والذي يسبب تغيير أشكالها وأبعادها يأتي كرد فعل لمقاومة التأثير المغناطيسي الواقع عليها. واستغلاً لهذه

الخاصة، فإنه يمكن تحفيز أو ممانعة تмагنط المادة الفيرومغناطيسية، فإذا كان الجسم ينكمش عند مغناطيسه في اتجاه ما، فإن تطبيق إجهاد ضاغط في هذا الاتجاه يساعد عملية التمagnetization، ويحدث العكس عند تطبيق إجهاد شد.



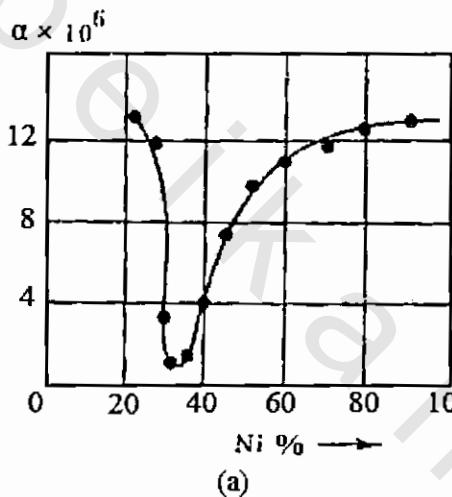
شكل (١٠-١١): تأثير التمagnetization على
أبعاد المواد الفيرومغناطيسية

كذلك عندما تتمagnetization المادة الفيرومغناطيسية في مجال مغناطيسي متعدد، فإن أبعادها تتغير بتردد يساوى ضعف تردد المجال المستخدم. وقد استخدمت هذه الخاصية في عمل متذبذبات مغناطيسية magnetostriction Oscillator تولد اهتزازات فوق صوتية يصل تردداتها إلى عدة ميجا هيرتز، والتي أصبحت تستخدم في العديد من المجالات مثل الطب، تنظيف الأدوات الصلبة، وقياس أعماق المياه في الأرض... الخ.

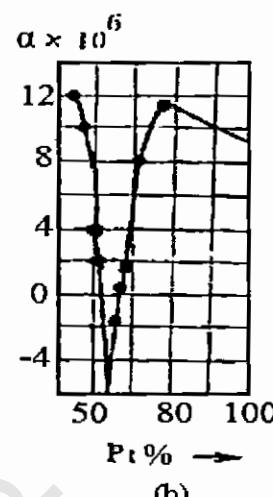
تأثير الحراري على أبعاد المادة الفيرومغناطيسية

كما نعلم أن التمدد الحراري للأجسام الصلبة ينشأ نتيجة الاهتزاز الحراري غير التوافقي للذرات حول مواضع استقرارها. وكما بینا، فإن التغير الحراري للمواد الفيرومغناطيسية يكون مصحوباً بتغير في درجة تمagnetization، مما يؤدي إلى تغير أبعادها. فإذا رمزنا لمعامل التمدد الطولي الحراري بالرمز α_1 والمغناطيسي بالرمز α_2 ، فإن معامل التمدد الطولي الكلي يكون مساوياً لمجموع معاملى التمدد، أي أن $\alpha_{\text{total}} = \alpha_1 + \alpha_2$ ، حيث α_1 دائماً موجب، بينما α_2 يمكن أن يكون موجباً أو سالباً. شكل (11-11a & b) يبيّن تغير α مع نسبة المكونات للسبائك حديد-نيكل، حديد-بلاتين على الترتيب. نلاحظ أن للسبائك التي تحتوي تقريباً على 36% نيكل تقل بحدود 10 مرات عن

قيمتها للنيكل النقي أو الحديد النقي، وتكون سالبة للسبيكة التي تحتوى على 56% بلاتين، أى أن هذه السبيكة لا تتمدد مع التسخين بل على العكس تنكمش. وبناء على ذلك، يمكن الحصول على مادة لها معامل تمدد حراري موجب أو سالب أو صفر طبقاً لمتطلبات الصناعة. لذلك، يعد التأثير الحراري للمواد الفيرو-مغناطيسية واحداً من التأثيرات الهامة من الناحية التطبيقية.



(a)



(b)

شكل: (11-11) اعتماد معامل التمدد الطولى على نسب مكونات السبيكة حديد- نيكل (a)
والسبائك حديد- بلاتين (b)

■ ■ ■

الخواص المغناطيسية للذرات

العزم المغناطيسي الذري atomic magnetic moment
العزم المداري Orbital moment

الذرة عبارة عن نواة ذات شحنة موجبة وغلاف إلكتروني، وطبقاً لنظرية بوهر فإن الإلكترونات الغلاف تتحرك في مدارات محددة، وينشأ عن كل إلكترون تيار قيمته هي $I = qv$ (حيث v هو تردد الدوران للإلكترون في الدار، q شحنته)، ونتيجة لدوران متوجه التيار حول الدار ينشأ عزم مغناطيسي مداري μ (شكل 11-12) يعطى من العلاقة الآتية:

$$\mu_\ell = I S = -qvS$$

$$v = v/2\pi r \quad \& \quad S = \pi r^2$$

$$\therefore M = \mu_\ell = -\frac{qvr}{2} \quad (11-17)$$

حيث v هي السرعة الخطية للإلكترون على محيط الدار. والعزم المغناطيسي M الناتج عن دوران الإلكترون يكون عمودياً على مستوى الدار طبقاً لقاعدة حلزون اليد اليمنى شكل (11-12).

وكمية التحرك المدارية الزاوية Orbital angular momentum (P_ℓ) للإلكترون تعطى من العلاقة الآتية:

$$P_\ell = m_0 vr \quad (11-18)$$

وبالتعويض عن vr من (11-81) في (11-17) نجد أن:

$$\mu_\ell = -\frac{q}{2m_0} P_\ell \quad (11-19)$$

أى أن اتجاهي P_ℓ ، μ متضادان.

وتكون النسبة γ بين العزم وكمية التحرك المداريين هي:

$$\gamma_\ell = \frac{\mu_\ell}{P_\ell} = -\frac{q}{2m_0} \quad (11-20)$$

وتعرف بالنسبة الجيرومغناطيسية gyromagnetic ratio.

ولقد بيّنت الميكانيكا الكمية أن كلاً من P_ℓ ومسقطها P_{H} في اتجاه المجال المغناطيسي H يمكنهما فقط أن يأخذَا قيمَاً منفصلة طبقاً للعلاقاتين الآتتين:

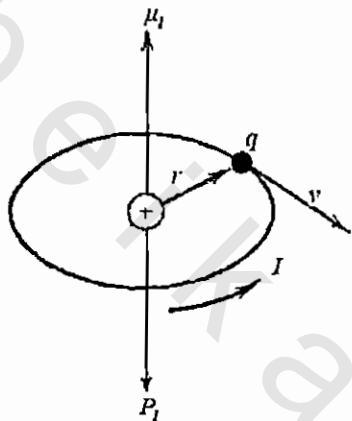
$$p_\ell = \hbar \sqrt{\ell(\ell + 1)} \quad (11 - 21)$$

$$p_{\ell H} = m_\ell \hbar \quad (11 - 22)$$

يعرف ℓ بالعدد الكمي المداري Orbital quantum number ويأخذ القيم المنفصلة التالية:

$$\ell = 0, 1, 2, \dots, n$$

$$(11 - 23)$$



شكل (11 - 12): العزم المغناطيسي الناشئ عن دوران متوجه التيار في الذرة

وعددتها الكلى n حيث n هو العدد الكمى الرئيسي principal quantum number. ويعرف بالعدد الكمى المغناطيسي magnetic quantum number ويأخذ قيمها منفصلة عددها $1 + 2\ell$ كالتالى:

$$m_\ell = -\ell, -(\ell - 1), \dots, 0, \dots, +\ell \quad (11 - 24)$$

وبالتالى، فإن العزم المغناطيسي μ_l ومركته H يمكن أن يأخذوا قيمها منفصلة كالتالى:

$$\mu_\ell = -\frac{q}{2m_0} \hbar \sqrt{\ell(\ell + 1)} = -\mu_B \sqrt{\ell(\ell + 1)} \quad (11 - 25)$$

$$\& \mu_{\ell H} = -\frac{q}{2m_0} P_{\ell H} = -m_\ell \mu_B \quad (11 - 26)$$

حيث:

$\mu_B = -\frac{q\hbar}{2m_0} = 9.27 \times 10^{-24} \text{ A.m}^2$ Bohr magneton، وهي «كم» العزم المغناطيسي المأخذ كوحدة لقياس العزوم المغناطيسية للأنظمة الذرية. والعزم المغناطيسي المداري الكلى يساوى مجموع العزوم لكل الإلكترونات التي يتكون

منها الغلاف الإلكتروني. فإذا كان الغلاف الإلكتروني مكتملاً، فإن العزم المغناطيسي يساوى صفرًا، وتكون الذرات التي غلافها الإلكتروني مليء جزئياً هي فقط التي لها عزم مغناطيسي مداري مختلف عن الصفر. وحتى في هذه الحالة الأخيرة، إذا كان الغلاف المليء جزئياً يقع قريباً من الغلاف الخارجي وكان تفاعل الذرات في الجسم الصلب قوياً، فإن عملية توجيه العزوم المغناطيسي لهذا الغلاف في المجال الخارجي ستكون معطلة أو مجمدة، وبالتالي فإن الإلكترونات هذا الغلاف لا تشارك عملياً بأى جزء في ت מגفط المادة. مثل هذا التصرف للعزوم المغناطيسي المدارية يكون موجوداً لـ الإلكترونات الغلاف $3d$ المليء جزئياً في العناصر الخاصة بمجموعة الحديد.

العزم المغزلي Spin moment

بالإضافة إلى كمية التحرك الزاوية المدارية يمتلك الإلكترون كمية تحرّك مغزليّة P_s تعطى قيمتها بواسطة الميكانيكا الكمية كالتالي:

$$P_s = \sqrt{3} \frac{\hbar}{2} \quad (11 - 27)$$

ومركبة في اتجاه H تأخذ القيمتين التاليتين:

$$P_{sH} = \pm \frac{\hbar}{2} \quad (11 - 28)$$

وت نتيجة لهذه الحركة المغزليّة للإلكترون ينشأ عزم مغناطيسي مغزليّاً، أمكن تحديد قيمة مركبته في اتجاه المجال عملياً بواسطة أوتوستيرن Ottostern ووالثر جيرلاخ Gerlach ووجدا أنها تساوي قيمة وحدة عزم مغناطيسي ذري (بوهر ماجنيتون) ..

$$i.e \quad \mu_{sH} = \pm \mu_B = \pm \frac{q\hbar}{2m_0} = -\frac{q}{m_0} \left(\pm \frac{\hbar}{2} \right) = -\frac{q}{m_0} P_{sH} \quad (11 - 29)$$

حيث تشير الإشارة السالبة إلى طبيعة شحنة الإلكترون السالبة. وتكون النسبة γ_S بين العزم وكمية التحرّك المغزليين للإلكترون هي:

$$\gamma_S = \frac{\mu_{sH}}{P_{sH}} = -\frac{q}{m_0} \quad (11 - 30)$$

وهي تساوي ضعف قيمتها للعزوم المدارية.

في الذرات التي تحتوي عدداً كبيراً من الإلكترونات فإن P_s لابد أن تجمع

كمتجهات. والعزم المغناطيسي المغزلي الكلى للأغلفة المغلقة تساوى صفرًا كما هو الحال بالنسبة للعزم المداري. جدول (11-3) يعطى مثلاً للعزم المغزلي (spin) في حالة الغلاف $3d$ لذرة مفردة من ذرات عناصر مجموعة الحديد، حيث يحدث تعويض أو إلغاء للعزم بقدر معين يعتمد على نوع العنصر. هذا التعويض يكون أقل ما يمكن في حالات ذرتي الـ Mn والمنجنيز Cr ، وبالتالي فإنهما يملكان أقصى قيمة للعزم المغزلي الكلى. هذه القيم لا تظل كما هي في حالة الجسم الصلب، بل عادة تكون أقل. فمثلاً في حالة الحديد فإن عدد الماجنتون لا يساوى 4 بل يساوى 2.2 فقط، وفي الكروميميوم يساوى 0.4 وفي المنجنيز يساوى 0.5.

جدول (3-11): العزم المغزلي للذرة لعناصر مجموعة الحديد.

العنصر	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni
العزم المغزلي	↓	↓↓	↓↓↓	↓↓↓↓	↓↓↓↓	↑↓↓↓↓	↑↓↑↓↓↓	↑↓↑↓↓↓
العزم الكلى	1	2	3	5	5	4	3	2

العزم المغناطيسي للنواة moment of nucleus

نواة الذرة تمتلك أيضاً عزماً مغناطيسياً مغزلياً يعطى بعلاقة مماثلة للعلاقة (29-11). ولها كانت كتلة النواة تساوى تقريباً 10^3 مرة من كتلة الإلكترون، فإن العزم المغناطيسي للنواة يكون أقل بمقدار 10^3 مرة منه للإلكترون. لذلك فإنه من الناحية التقريرية يمكن إهمال التأثير المغناطيسي للنواة على الخصائص المغناطيسية للمادة. وهذا لا يعني عدم أهمية التأثير المغناطيسي للنواة، حيث أنه في بعض الظواهر التي لا مجال لذكرها هنا يلعب التأثير المغناطيسي للنواة دوراً هاماً.

العزم الكلى للذرة Total magnetic moment

كما ذكرنا، في الذرة عديدة الإلكترونات تتجمع كميات الحركة المدارية ذات الاتجاهات المختلفة (متوجهها) لتعطى كمية التحرك المداري المحصلة للذرة والتي تتصرف

بالعدد الكمي L ، وبالمثل تتجمع كميات التحرك المغزليه لتعطى محصلة التحرك المغزلي التي تتصف بالعدد الكمي S ، وفي النهاية تتجمع $S & L$ لتنتج كمية التحرك الكلية للذرة والتي تتصف بالعدد الكمي J . لذلك لإيجاد العزم المغناطيسي الكلى للغلاف الإلكترونى للذرة نتبع الخطوات التالية:

أولاً: نوجد كمية التحرك المدارية الكلية P_L ، حيث:

$$P_L = \sum_i P_{Li} \quad (11 - 31)$$

P_{Li} هي كمية التحرك المدارية للإلكترون i . وتعطى القيمة الحسابية لكمية التحرك P_L كالتالى :

$$P_L = \hbar \sqrt{L(L+1)} \quad (11 - 32)$$

العدد الكمي L يأخذ أى عدد صحيح بين القيمتين القصوى والصغرى للمجموع الجبrij \sum_i ، حيث \sum_i هو العدد الكمى المدارى للإلكترون i . ثانياً : نوجد كمية الحركة المغزليه P_S ، حيث:

$$P_S = \sum_i P_{Si} \quad (11 - 33)$$

حيث P_{Si} هي كمية الحركة المغزليه للإلكترون i ، وتعطى القيمة الحسابية لكمية التحرك P_i بدلالة العدد الكمى S كالتالى:

$$P_S = \hbar \sqrt{S(S+1)} \quad (11 - 34)$$

العدد S يأخذ قيمات متعددة بين القيمة القصوى والصغرى للمجموع الجبrij $\sum_i S_i$ هو العدد الكمى المغزلى للإلكترون i) بحيث يكون الفرق بين أى قيمتين متواليتين للعدد S يساوى الوحدة.

وأخيراً: تعطى كمية التحرك الذريه الكلية P_J بالمجموع الاتجاهى لكميتي التحرك المدارية والمغزليه.

$$\text{i.e } P_J = P_L + P_S \quad (11 - 35)$$

وتتحدد قيمتها العددية بالعدد الكمى الكلى الذاتى J حيث:

$$P_J = \hbar \sqrt{J(J+1)} \quad (11 - 36)$$

$$, \quad J = L + S, L + S - 1, \dots, L - S ; L > S$$

$$J = S + L, S + L - 1, \dots, S - L ; S > L \quad (11 - 37)$$

وقيم P_J المسموحة في المجال الخارجي هي تلك القيم التي مركباتها في اتجاه المجال تساوى مضاعفات \hbar .

$$\text{i.e } P_{JH} = m_J \hbar \quad (11 - 38)$$

حيث m_J يسمى العدد الكمي المغناطيسي ويعطى بالعلاقة الآتية :

$$m_J = J, J-1, \dots, 0, 1, 2, \dots, -J \quad (11 - 39)$$

أى أن العدد الكلى لقيمة m_J يساوى $+J$. ويكون العزم المغناطيسي الكلى للذرة (يسمى عادة بالعزم الفعال M_{eff}) المقابل لكمية التحرك الكلية P_J هو :

$$M_J = -g\mu_B \sqrt{J(J+1)} = M_{\text{eff}} \quad (11 - 40)$$

ومركبته في اتجاه المجال الخارجي هي :

$$M_{JH} = -m_J g \mu_B \quad (11 - 38)$$

$$g = 1 + \frac{J(J+1) + S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)} \quad (11 - 42)$$

يعرف g بمعامل لاند (Lande factor)، حيث عندما تكون المغناطيسيّة مغزلية كليّة ($S = L$ & $J = L$)، تكون $g = 2$ ، وعندما تكون المغناطيسيّة الكليّة مدارية ($S = 0$ & $L = 0$)، تكون $g = 1$.

ومصطلح العزم المغناطيسي الذري يقصد به القيمة القصوى للمركببة M_{JH} العلاقة (11-41) وليس المقدار M_J المعطى بالعلاقة (11-40).

وقيمة العدد J للذرة يمكن أن تكون عدداً صحيحاً أو نصف عدد صحيح ويكون لها

$$\text{قيمة مسموحة في المدى } 0 \leq J \leq \frac{1}{2}.$$

- عندما $J = 0$ ، يوجد عدد لانهائي لقيم J تقابل عدداً لانهائياً لاتجاهات العزم.

وهذا يمثل حالة التوزيع الكلاسيكية (شكل 13.a)، حيث يمكن للعزوم أن تأخذ قيمها مستمرة في أي اتجاه في المساحة المظللة.

- عندما $\frac{1}{2} = J$ تخص الحركة المغزلية الخالصة دون مشاركة من الحركة المدارية ($g = 2, J = S = 1/2, L = 0$)، وذلك لأن قيمة m_J تنقص من $J + 1$ إلى $J - 1$ على خطوات كمية كل منها تساوى الوحدة. هذه القيم هي $\frac{1}{2}^+, \frac{1}{2}^-$ ، وتكون القيم المسموحة المقابلة للعزم هي μ_B ، $-\mu_B$ - الموازي والمضاد لاتجاه المجال المغناطيسي على الترتيب (شكل 13.b).

- وعندما $J = 1$ ، فإن العدد m_J يكون له خمسة قيم هي :

$$J, J - 1, 0, -(J - 1), -1 \equiv 2, 1, 0, -1, -2$$

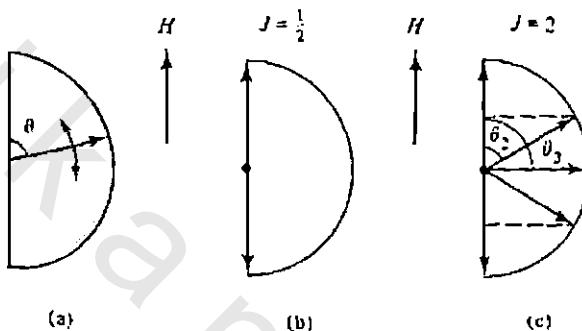
ويكون للعزم المغناطيسي M_{JH} إحدى القيم الخمسة الممثلة في شكل (11-13.c) كالتالي:

$$2g\mu_B, g\mu_B, 0, -g\mu_B, -2g\mu_B$$

وتكون القيمة القصوى للعزم مساوية $2g\mu_B$ عندما $J = m_J$. لذلك تعطى القيمة العظمى للعزم بالصورة التالية:

$$M_{JH} = gJ\mu_B \quad (11 - 43)$$

حيث J هي أكبر قيمة للعدد m_J .



شكل (11-13): الإتجاهات المسموحة للعزم المغناطيسي

لهذا، يكون العزم المغناطيسي لذرة الهيدروجين في وضع الاستقرار ($L = 0$, $L = 0$) مساوياً للوحدة μ_B ، ولذرة الحديد ذات العزم المداري المعطل ($L = 0$, $g = 2, J = S = 1/2$) يكون مساوياً $4\mu_B$ ، ويكون لكل الذرات والآيونات ذات الأغلفة المغلقة ($J = 0, L = 0, S = 0$) مساوياً للصفر.

وكما أسلفنا، تنشأ البارامغناطيسية بسبب وجود ذرات لها أغلفة مليئة جزئياً. وتبعاً لبداً باولى فإنه لا يمكن تواجد أكثر من إلكترونين مختلفي الحركة المغزلية في الحالة الواحدة، حيث يكون العزم المغزلي الكلى لهما يساوى صبراً. هذان الإلكترونون يسميان ثنائى متزاوج (paired). فإذا كانت ذرة أو آيون يحتوى على عدد أحادى (odd) من الإلكترونات، فلابد أن واحداً منها يكون غير متزاوج (unpaired)، وبالتالي يكون للذرة عزم مغناطيسي دائم. وإذا كانت الذرة تحتوى على عدد زوجي (even) من الإلكترونات، فإنه يكون لدينا احتمالان، إما كل الإلكترونات متزاوجة وبالتالي يكون

العزم المغناطيسي الكلى مساويا للصفر، أو اثنان أو أكثر من الإلكترونات غير متزاوجة، وبالتالي يكون للذرة عزم مغناطيسي دائم.

ذرات العناصر H, K, Na, Ag يملك كل منها عددا فرديا من الإلكترونات، منها إلكترون مفرد غير متزاج، أما ذرات Be, C, He, Mg، فكل منها يحتوى على عدد زوجي من الإلكترونات وكلها متزاوجة، ويحتوى الأكسجين على عدد زوجي من الإلكترونات، اثنان منهم غير متزاوجين.

والعزم المغناطيسي لمعظم الجزيئات يساوى صفرًا لعدم احتوايتها على إلكترونات غير متزاوجة. القليل منها فقط يحتوى على إلكترونات غير متزاوجية مثل جزيئات الراديکال الحرة، ومنها الهيدروكسيل (OH)، الميثيل (CH_3), الإيثيل (C_2H_5) ووجود الإلكترونات غير المتزاوجة في هذه الجزيئات الحرة يجعلها جزيئات مغناطيسية.

■ ■ ■

مصدر المغناطيسية في المواد

Origin of magnetism in Substances

تصنيف المواد المغناطيسية

عندما يجمع العزمان المغناطيسيان الدارى والمغزلى معا فإنه يمكن أن يحدث تعويضا كاملا، وبالتالي يصبح العزم المغناطيسى الكلى للذرة يساوى صفراء. وإذا لم يحدث التعويض فإن الذرة تمتلك عزما مغناطيسية دائئرا. لذلك فالخواص المغناطيسية للأجسام لابد أن تكون مختلفة شكل (14-11)، فالمواد التي ذراتها لا تمتلك عزما مغناطيسيا تعرف، كما نعلم، بالمواد الديامغناطيسية، أما المواد التي تمتلك عزما دائما يمكن أن تكون إما بارا أو فيرو أو أنتيفيرو أو فيريمغناطيسية. وعموما إذا كان التفاعل بين العزوم المغناطيسية للذرات يساوى صفراء أو ضعيفا جدا تكون المادة بارا مغناطيسية (شكل 14-11a)، وإذا كانت



شكل (14-11): نوع المادة المغناطيسية يتحدد بشكل التفاعل بين العزوم

العزوم المغناطيسية المجاورة تنظم نفسها بحيث تكون متوازية وفي اتجاه واحد تكون المادة فيرومغناطيسية (شكل 14.6)، وإذا كانت العزوم المغناطيسية المجاورة تتفاعل مع بعضها بحيث تكون متوازية وكل اثنين متجاورين متضادان في الاتجاه فإن المادة

تكون أنتيغيفرومغناطيسية (شكل 11-14.c)، أما إذا كانت العزوم المغناطيسية متوازية وكل اثنين متجلرين متعاكسان وقيمتاهما مختلفتين فإن المادة فيرمغناطيسية (شكل 11-14.d).

مصدر الدايماغناطيسية

تنشأ الدايماغناطيسية نتيجة التغير في الحركة المدارية للإلكترونات الواقعة تحت تأثير مجال مغناطيسي. وهذا التأثير يعتبر تأثيرا عاما لكل المواد، إلا أنه يهم غالبا في حالة البارامغناطيسية والفيرومغناطيسية بسبب قوتها المغناطيسية. والمادة الدايماغناطيسية في حالتها الندية تعامل على أنها مواد عزّمتها المغناطيسى الذري الكلى يساوى صفراء.

تغير الحركة المدارية في المجال المغناطيسي

نفرض أن إلكتروننا يتتحرك في مدار نصف قطره r كما في شكل (11-15.a). في حالة عدم تأثير مجال مغناطيسي يتتأثر الإلكترون بقوة جذب نحو المركز F_{CP} Centripetal force تساوى قوة الطرد المركزي، أي أن $F_{CP} = m_0 \frac{v^2}{r}$ ، حيث v_0 هي سرعتنا الإلكترون الخطية والزاوية على الترتيب. وعندما يؤثر مجال H عموديا على مستوى المدار، فإن الإلكترون يتتأثر بقوة إضافية F_L تعرف بقوة لورنس قيمتها $F_L = qv_0 B_0$ واتجاهها في اتجاه نصف القطر نحو مركز المدار، وتكون قوة الجذب الكلية نحو المركز هي:

$$F = F_{CP} + F_L$$

ونصبح قوة الطرد المركزي التي تتوافق مع قوة الجذب F هي كالتالي:

$$\frac{m_0 v^2}{r} = m_0 \omega^2 r = m_0 \omega_0^2 r + q \omega_0 r B_0$$

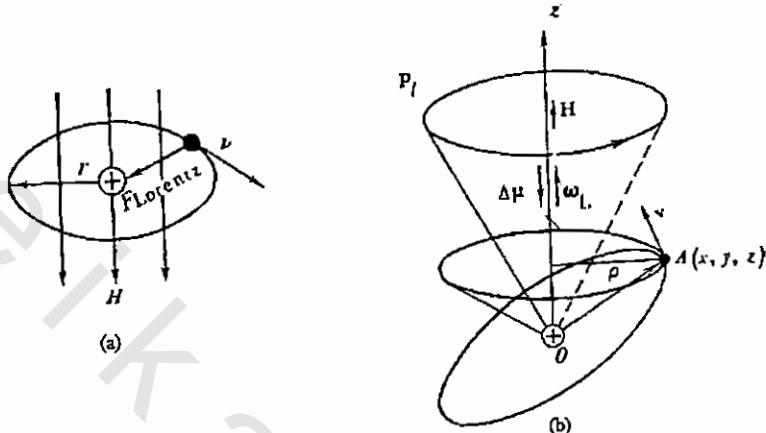
$$\text{i.e. } m_0 (\omega^2 - \omega_0^2) = q \omega_0 B_0$$

وبوضع $\omega = \omega_0 + \omega_L$ نجد أن:

$$2m_0 \omega_0 \omega_L \approx q \omega_0 B_0 \quad (11 - 44)$$

$$\text{i.e. } \omega_L = \omega - \omega_0 = \frac{qB_0}{2m_0} = \frac{q}{2m_0} \mu_0 H \quad (11-45)$$

حيث ω هي مقدار التغير في التردد الزاوي نتيجة تأثير المجال المغناطيسي وتسمي تردد لarmor الزاوي (Larmor angular frequency).



شكل (11-15): تغير الحركة الدارية للإلكترون في المجال المغناطيسي عندما يكون عمودياً (a) أو غير عمودياً (b) على مستوى مدار الإلكترون

وهكذا يتضح أن المجال المغناطيسي يغير التردد الزاوي للحركة الدارية للإلكtron، وكما تبين العلاقة (11-45)، فإن التغير الحادث في التردد الزاوي يكون واحداً لكل الإلكترونات بغض النظر عن قيمة نصف قطر المدار أو قيمة سرعة الإلكترون وأن اتجاهه ينطبق مع اتجاه H . وعندما يكون H غير عمودي على سطح المدار فإن متوجه كمية التحرك الزاوي يرسم P مخروطاً حول اتجاه H (شكل 11-15.b). ولقد بيّنت الحسابات أن التردد الزاوي في هذه الحالة يعطى بنفس العلاقة. (11-45)

القابلية المغناطيسية للمواد الدايمغناطيسية

ما سبق يتبين أنه نتيجة لتأثير المجال المغناطيسي يمكن أن تنتج حركة دارية إضافية للإلكترون حول المجال H . والتأثير المغناطيسي لهذه الحركة الإضافية يكافئ تأثير التيار الإضافي ΔI في المسار المغلق لهذه الحركة، حيث:

$$\Delta I = -qv_L = -\frac{q\omega_L}{2\pi} = -\frac{q^2}{4\pi m_0} B_0 \quad (11-46)$$

ω_L هو التردد الحادث نتيجة وجود المجال المغناطيسي، والإشارة السالبة تشير إلى شحنة الإلكترون السالبة.

العزم المغناطيسي لعنصر التيار ΔI هو:

$$\Delta \mu = \Delta I S = -\frac{q^2 S}{4\pi m_0} B_0 \quad (11 - 47)$$

حيث S هي المساحة المحددة بواسطة مسار الإلكترون في هذه الحركة حول المجال H . ولقد بينت الحسابات أن $S = 2\pi \bar{r}^2$ حيث \bar{r}^2 هو متوسط مربع مسافة الإلكترون من النواة، لذلك فإن:

$$\Delta \mu = -\frac{q^2 \bar{r}^2}{6m_0} B_0 = -\frac{q^2 \bar{r}^2}{6m_0} \mu_0 H \quad (11 - 48)$$

يتضح من العلاقة (11-48) أن كل إلكترون يكتسب عزماً مغناطيسياً إضافياً اتجاهه يضاد اتجاه المجال المغناطيسي المؤثر H . وظهور هذا العزم هو السبب في تغميد الجسم في اتجاه مضاد لاتجاه المجال المغناطيسي، وهي خاصية للمادة الدايماغناطيسية. وبجمع عزوم كل الإلكترونات نحصل على العزم المغناطيسي الكلي للذرة، فإذا كانت الذرة تحتوي على z من الإلكترونات فإن عزومها المغناطيسي الناتج يكون هو:

$$\Delta M = -\frac{q^2 B_0}{6m_0} \sum_i^z \bar{r}_i^2 \quad (11 - 49)$$

حيث \bar{r}_i^2 هو متوسط مربع المسافة للإلكترون رقم i من النواة، وبوضع $\bar{a}^2 = za^2$ حيث \bar{a}^2 هو متوسط مربع المسافة لكل الإلكترونات من النواة، فإن:

$$\Delta M = -\frac{q^2 B_0}{6m_0} \sum_i^z \bar{r}_i^2 \quad (11 - 49)$$

وبضرب العلاقة (11-50) في عدد الذرات لوحدة الحجم n نحصل على التمغنطية J_m كالتالي:

$$\Delta M = -\frac{zq^2 \bar{a}^2}{6m_0} B_0 \quad (11 - 50)$$

والقابلية المغناطيسية χ تكون:

$$J_m = n \Delta M = -\frac{zq^2 n \bar{a}^2 B_0}{6m_0} = -\frac{zq^2 n \bar{a}^2}{6m_0} \mu_0 H \quad (11 - 51)$$

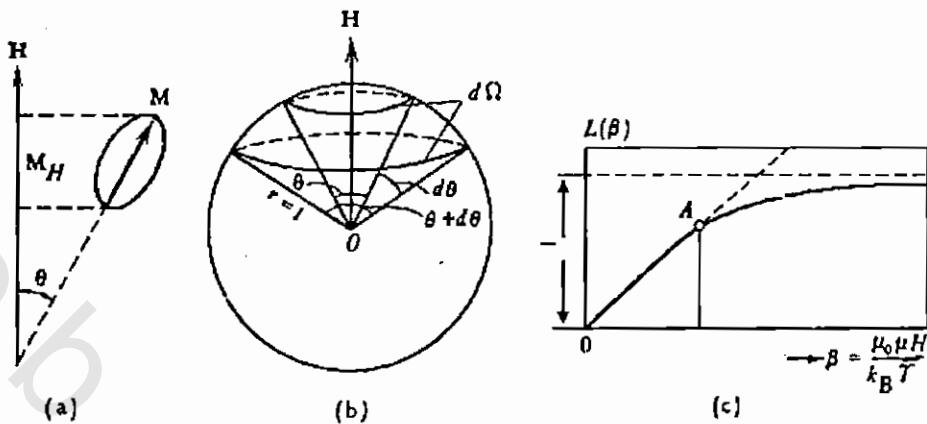
فإذا كانت $\chi = 10^{-6} \text{ m}^{-3}$ ، $n \approx 5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$ ، $a \approx 10^{-10} \text{ m}$ ، $\chi = 10^{-6} z$ ، هذه القيمة تتفق تماماً مع النتائج العطاء في جدول (11-52). كذلك توضح العلاقة أن القابلية المغناطيسية للمواد الديامغناطيسية لا تعتمد على أي من درجة الحرارة أو شدة المجال H وتزداد طردياً مع العدد الذري للعنصر Z ، وهذا يتفق أيضاً مع النتائج التجريبية.

منشأ البارامغناطيسية نظيرية لانجفين الكلاسيكية

بنيت النظرية الكلاسيكية للبارامغناطيسية التي طورت بواسطة بأول لانجفين على فكرة أن ذرات المواد البارامغناطيسية تمتلك أصلاً عزماً مغناطيسياً دائماً « M »، أي أن هذه الذرات تمتلك عزوم ثبائي قطب مغناطيسية دائمة وأن تفاعಲها فيما بينها يجعلها مهملة القيمة. طاقة مثل هذا العزم المغناطيسي في المجال H تعطى من العلاقة الآتية:

$$U_m = -M\mu_0 H \cos\theta \quad (11-53)$$

حيث θ هي الزاوية بين H & M (شكل 11-16.a). واضح أن القيمة الصغرى للطاقة $U_m = 0$ تقابل $\theta = 0$ ، ولذلك تحاول كل عزوم ثبائيات الأقطاب أن توجه نفسها في اتجاه المجال الخارجي كي تكون طاقتها أقل ما يمكن، إلا أن عملية التوجيه هذه يمكن أن تعاون بواسطة الحركة الحرارية، ولما كان تمغنت المادة يتحدد بمركبة العزم المغناطيسي الكلي في اتجاه المجال M_H (والتي تعطى بواسطة مساقط العزوم الذرية المغناطيسية لكل ذرة في اتجاه H ، حيث $M_H = M \cos \theta$) فإن الحساب الكمي لتمغنت المادة يستلزم حساب متوسط قيمة M_H التي تقابل حالة الاتزان بين تأثير المجال (الذى يحاول توجيه العزوم في اتجاهه) وتأثير الحركة الحرارية (الذى تحاول إعاقة هذا التوجيه). لذلك، استخدم العالم لانجفين طرق الإحصاء الكلاسيكية محاولاً إيجاد صيغة مناسبة للقيمة المتوسطة للعزم M_H ، حيث افترض أن التوجيه للعزم المغناطيسي M بالنسبة للمجال H يكون احتمالياً ويعتمد على قيمة الزاوية θ ، وتعامل النظرية الكلاسيكية مع الطاقة وبالتالي مع الزاوية θ على أنها متغيران مستمران، والعزوم المغناطيسي يمكن أن يكون واقعاً عند أي زاوية في المجال (أنظر شكل 11-13.a). عموماً، فلقد أخفقت النظرية الكلاسيكية في إعطاء تفسير مناسب للظواهر المغناطيسية الناتجة بسبب حركة الشحنات الكهربائية، في حين أنه أمكن بواسطة النظرية الكمية تحسين التوافق بين القيم النظرية والعملية للظواهر المغناطيسية.



شكل (11-16): النظرية الكلاسيكية للبارامغناطيسية. الغزם المغناطيسي ومسقطه في اتجاه المجال (a)، حساب العزم المغناطيسي الكلي للبارامغناطيسية (b) وتمثيل دالة لانجفين (c).

النظرية الكمية للبارامغناطيسية

الفرض الأساسي للنظرية الكمية هو أن طاقة النظام لا تتغير بشكل مستمر، ولكنها تتغير بكميات منفصلة تسمى «كم طاقي»، فإذا كانت طاقة النظام دالة في الزاوية كما تبين المعادلة (11-53)، فإن الزاوية لا بد أن تتغير كمياً وتأخذ قيمًا محددة $\theta_1, \theta_2, \dots$ والقيم البينية تكون غير مسموحة، وهذا هو بالضبط حالة البارامغناطيسية. يوجد $J+1$ طريقة يمكن للعزم المغناطيسي الذري M_J أن يوجه نفسه بواسطتها في المجال المغناطيسي (حيث J هو العدد الكمي الذاتي). احتمال حدوث أي من هذه الطرق يتحدد بـ دالة التوزيع لبولتزمان كالتالي:

$$W = Ce^{\frac{\mu_0 M_{JH} H}{k_B T}}$$

حيث M_{JH} هو مسقط M_J في اتجاه H ، وتعطى القيمة المتوسطة \bar{M}_{JH} كما يلى:

$$\bar{M}_{JH} = \frac{\sum_{-J}^{+J} M_{JH} \exp\left(\frac{\mu_0 M_{JH} H}{k_B T}\right)}{\sum_{-J}^{+J} \exp\left(\frac{\mu_0 M_{JH} H}{k_B T}\right)} \quad (11-54)$$

وبإيجاد قيمة هذه المجاميع نحصل على:

$$\bar{M}_{JH} = g J \mu_B B_J(\beta) \quad (11 - 55)$$

$$\beta = \frac{J g \mu_B H \mu_0}{k_B T} \quad (11 - 56)$$

$$\& \quad B_J(\beta) = \left(\frac{2J+1}{2J} \right) \coth \left[\frac{(2J+1)\beta}{2J} \right] - \frac{1}{2J} \coth \left(\frac{\beta}{2J} \right) \quad (11 - 57)$$

الدالة $B_J(\beta)$ تسمى دالة بريليون Brillouin function. وتصبح كل من التمغnetية والقابلية المغناطيسية كالتالي:

$$J_m = \bar{M}_{JH} N = N g J \mu_B B_J(\beta) \quad (11 - 58)$$

$$\chi = \frac{N g J \mu_B B_J(\beta)}{H} \quad (11 - 59)$$

حيث N عدد الذرات في وحدة الحجم.

ولقيمة $1 \ll \beta$ فإن:

$$B_J(\beta) \approx \frac{\beta(J+1)}{3J}$$

$$\therefore J_m = \frac{N g^2 \mu_B^2 J(J+1) \mu_0 H}{3 k_B T} \quad \& \quad \chi = \frac{N J(J+1) g^2 \mu_B^2 \mu_0}{3 k_B T} \quad (11 - 60)$$

ويتبين من العلاقة (11-60) أن لقيمة $1 \ll \beta$ فإن J_m & H يرتبطان بعلاقة خطية، بينما يتناصف عكسيا كل من χ مع J_m & T ، وهذا متفق مع النتائج العملية. أما في حالة المجالات القوية وعند درجات الحرارة المنخفضة جداً فإن:

$$\beta \rightarrow \infty$$

$$\& \quad \coth \left[\frac{(2J+1)\beta}{2J} \right] \rightarrow 1, \quad \coth \left[\frac{\beta}{2J} \right] \rightarrow 1 \quad \& \quad B_J(\beta) \rightarrow 1$$

وتصل التمغnetية إلى قيمتها التشبعية الآتية:

$$J_s = N g J \mu_B \quad (11 - 61)$$

وتكون القيمة القصوى للعزز لكل ذرة هي:

$$M_{JH} = g J \mu_B$$

وهي نفس العلاقة (11 - 43) التي حصلنا عليها في أثناء مناقشة العدد الكمى J . ولقد تم اختبار هذه النظرية باستخدام محاليل وأملاح بللورية مثل آيونات عنصر

مجموعات الحديد والعناصر الأرضية النادرة حيث تحتوى على آيونات عزمها لا يساوى صفراء، بالإضافة إلى أن آيوناتها بعيدة عن بعضها بحيث يمكن إهمال التفاعلات بينها، (وهو شرط ضروري للمواد البارامغناطيسية) وكانت النتائج تماماً مع النظرية.

البارامغناطيسية للغاز الإلكتروني Paramagnetism of electron gas

يؤكد كل من قانون كوري والعلاقة (11-60) أن القابلية المغناطيسية χ تتناسب عكسياً مع درجة الحرارة. هذا الاستنتاج تبين أنه ليس صحيحاً لكل المواد، فقد لوحظ أن تمعنط معظم المعادن العادي (غير الفيرو-مغناطيسية) لا تعتمد على درجة الحرارة. ولقد أعزى ولفانج باول ذلك إلى البارامغناطيسية للإلكترونات الحرة المكونة للغاز الإلكتروني.

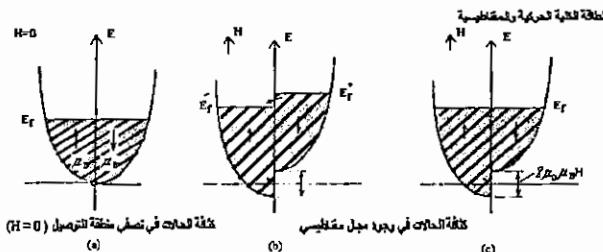
شكل (11-17.a) يبيّن منطقة التوصيل في المعدن عند درجة الصفر المطلق، حيث تنقسم إلى نصفين يحتويان على إلكترونات عزومها المغزلي (μ_B) مختلفة الاتجاه في أحد النصفين عنه في النصف الآخر. عندما $H = 0$ ، يكون عدد الإلكترونات في نصف المنطقة واحداً، وبالتالي العزم المغناطيسي الكلي للغاز الإلكتروني يساوى صفراء. وعندما يطبق مجال شدته H فإن كل إلكtron في الجهة اليسرى يكتسب طاقة إضافية قدرها $H\mu_B - \mu_B$ وكل إلكترون في الجهة اليمنى يكتسب طاقة إضافية قدرها $H\mu_B + \mu_B$ ويكون الفرق في طاقتى مستوى فيرمي في الجانبين (شكل 11-17.b) هو:

$$E'_{f+} - E'_{f-} = 2\mu_0\mu_B H \quad (11-62)$$

ولما كان مستوى فيرمي لابد أن يكون عند مستوى طaci واحد في الجانبين، فإنه يمكن فقط لعدد Δn من الإلكترونات (التي يمكنها تغيير اتجاه حركتها المغزليّة) الانتقال إلى الأماكن الخالية في الجانب الأيسر كى تصبح طاقة مستوى فيرمي واحدة على الجانبين، ويعطى عدد هذه الإلكترونات بالعلاقة الآتية:

$$\Delta n \approx \frac{k_B T}{E_f} n$$

حيث n هو تركيز الغاز الإلكتروني.



شكل (11-17): البارامغناطيسية
للإلكترونات الحرة

جزء $\Delta n'$ من هذه الإلكترونات له عزم مغناطيسي متوجه في اتجاه H وجزء $\Delta n''$ يكون متوجه ضد H (حيث C مقدار ثابت)، ويكون العزم المغناطيسي لوحدة الحجم هو:

$$J_{me} = (\Delta n' - \Delta n'') \mu_B = c \mu_B (e^\beta - e^{-\beta})$$

$$\beta = \frac{\mu_0 \mu_B H}{k_B T}$$

حيث:
و بما أن

$$\Delta n = (\Delta n' + \Delta n'') = c (e^\beta + e^{-\beta})$$

$$c = \Delta n (e^\beta + e^{-\beta})^{-1}$$

فإن:

وبال subsituting في معادلة العزم المغناطيسي J_{me} نجد أن:

$$J_{me} = \frac{\Delta n \mu_B (e^\beta - e^{-\beta})}{(e^\beta + e^{-\beta})} = \Delta n \mu_B \tanh \beta$$

وعندما تكون $\beta \ll 1$ ، فإن:

$$\tanh \beta \approx \beta \quad \& \quad J_{me} = \Delta n \mu_B^2 \frac{\mu_0 H}{k_B T}$$

وبال subsituting عن قيمة Δn نحصل على :

$$J_{me} \approx \frac{n \mu_B^2 \mu_0 H}{E_f} \quad (11-63)$$

وتكون القابلية المغناطيسية للمواد البارامغناطيسية للغاز الإلكتروني هي:

$$\chi_e \approx \frac{n \mu_B^2 \mu_0}{E_f} \quad (11-64)$$

والحسابات الأكثر دقة بيّنت أن:

$$\chi_e = \left(\frac{3}{2}\right) \frac{n \mu_B^2 \mu_0}{E_f} \quad (11-65)$$

واضح من العلاقة (11-65) أن القابلية المغناطيسية للغاز الإلكتروني لا تعتمد على درجة الحرارة.

تبريد عينة بaramagnetic

تمتلك ذرات المواد البارامغناطيسية عزماً مغناطيسياً دائمًا، وفي حالة غياب المجال الخارجي و كنتيجة للحركة الحرارية للذرات تكون اتجاهات عزومها المغناطيسية عشوائية

بشكل كامل. ويستخدم عادة بaramتر الإنتروربيا (entropy) كمقاييس للعشوانية، حيث تسمى في هذه الحالة بالإنتروربيا المغناطيسية S_M ، وطبقاً لمبدأ بولتزمان فإن:

$$S_M = k_B \ln W_M$$

حيث W_M هو الاحتمال الثيرموديناميكي وهو عدد الطرق الممكنة للتوزيع n من الذرات بين $2J+1$ من المدارات الفرعية، قيمة هذا الاحتمال تعطى من العلاقة الآتية:

$$W_M = (2J+1)^n \\ i.e \quad S_M = n k_B \ln (2J+1)$$

عندما يؤثر المجال المغناطيسي وتزداد شدته فإن عدد العزوم المغناطيسية التي تتوجه في اتجاه المجال تزداد، وبؤدي ذلك إلى نقص الإنتروربيا المغناطيسية، ويصل الترتيب أقصى قيمة له في حالة التشبع المغناطيسي حيث تكون $S_M = 0$ ، ومعنى ذلك أن عملية تمغنت العينة البارامغناطيسية حتى درجة التشبع تكون مصحوبة بنقص في قيمة الإنتروربيا بالمقدار:

$$\Delta S = S_M - 0 = n k_B \ln (2J+1)$$

فإذا تمت عملية التمغنت عند درجة حرارة T فإن هذا النقص في الإنتروربيا يكون مصحوباً بفقدان في حرارة العينة بالمقدار $\Delta Q = T \Delta S$. هذه الحرارة تنتقل من العينة إلى الوسط المحيط. وكذلك إذا تم مغнطة العينة حتى تصل لمرحلة التشبع المغناطيسي ثم عزلت حرارياً عن الوسط فإنها تبدأ بالتدريج في هدم التمغنت أديباتيكياً (أي بدون الاعتماد على مؤثرات خارجية)، وينتظر عن ذلك زيادة الأنتروربيا بالمقدار ΔS . هذه الزيادة تتطلب كمية من الحرارة مقدارها ΔQ يمكن الحصول عليها من الاهتزازات الحرارية للشبكة (وذلك لأن العينة معزولة حرارياً عن الوسط المحيط). ونتيجة لذلك تنخفض درجة حرارة العينة، وبتكرار مغنطة العينة كما سبق يتكرر انخفاض درجة حرارتها أكثر فأكثر، وهذا يمكن أن تصل درجة حرارة العينة إلى $0.001K$.

منشأ الفيرومغناطيسية carriers of ferromagnetism

علمنا أن الجسم المغнет يكتسب عزماً مغناطيسياً M بسبب العزوم المغناطيسية الذرية ذات الاتجاه الواحد، كما يمتلك كمية تحرك زاوية P ناتجة عن المجموع

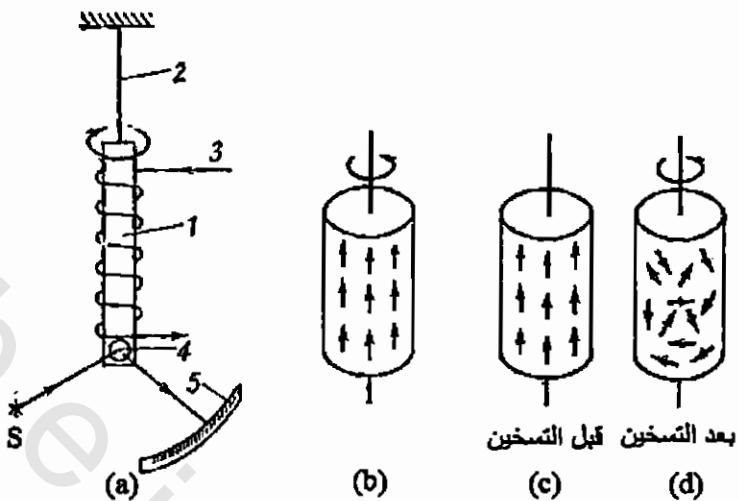
لكميات التحرك الزاوية الذرية موحدة الاتجاه. وأن النسبة $\frac{q}{2m_0} \frac{M}{P}$ لابد أن تساوى إذا كان التمغnet ناتجا عن العزوم المغناطيسية المدارية للذرات أو تساوى $\frac{q}{m_0}$ إذا كان التمغnet ناتجا عن العزوم المغزلية.

ولقد ظهر تعبير «عزم» مغناطيسى أول الأمر عندما قام أينشتين ودى هاس (A.Einstien & W.J.deHaas) بمعنطة قضيب من الحديد (1) معلق بخيط من (2) عن طريق ملف كهربى (3) فوجدوا أن القضيب دار وحدث إلتواء فى الخيط، حيث أمكن تقدير زاوية الالتواه θ باستخدام مرآه (4) تعكس ضوءا على تدریج (5) كما في شكل 11-18.a). وعزم الالتواء الناتج عن معنطة القضيب سمي بالعزم المغناطيسى، وبالتالي فلقد أمكنهما إيجاد العزم المغناطيسى M وكذلك كمية التحرك P . (العزم المغناطيسى = عزم الالتواء $\tau\theta$ ، وكمية التحرك الزاوي = عزم الالتواء X زمن إجراء التجربة، لأن معدل التغير فى كمية التحرك الزاوي = عزم الأزدواج أو عزم الالتواء). ومن ذلك أمكن إيجاد النسبة $M/P = \gamma$ وسميت هذه الظاهرة بتأثير أينشتين - ديهاس.

(Einstien deHass effect)

ولقد أجرى بارنيت (S.J.Barnett) هذه التجربة بطريقة عكسية، حيث درس عملية التمغnet الحادثة فى قضيب حديد يدور بسرعة. وسبب هذا التمغnet هو ميل الإلكترونات لترتيبها دورانها المغزلية فى اتجاه محور دوران الجسم (شكل). وفي تجربة أخرى قام الفيزيائيان إيف (A.F.Ioffe) & كابيتزا (P.L.Kapitza) بتسخين قضيب معنط من الحديد إلى درجة حرارة أعلى من نقطة كورى. قبل التسخين كان توجيه الإلكترونات منتظم وكمية التحرك الزاوية الكلية لا تساوى صفراء (شكل 11-18.c)، وبعد التسخين غيرت الإلكترونات (السطحية) توجهها لتصبح عشوائية وأصبحت كمية التحرك الزاوية الكلية تساوى صفراء (شكل 11-18.d). وبسبب ذلك فإن القضيب اكتسب كمية تحرك دورانية، حيث أمكن قياسها وكذلك قياس العزم المغناطيسى للقضيب المعنط وبالتالي أمكن إيجاد النسبة $M/P = \gamma$.

تبين من هذه التجارب أنه للمواد الفيرو-مغناطيسية تكون $q/m_0 = M/P = \gamma$ ، وهى تساوى نفس النسبة للعزوم المغزلي للإلكترون. وهذا يثبت أن الفيرو-مغناطيسية لا تكون ناتجة بسبب الحركة المدارية، ولكنها تنتج بسبب العزوم المغناطيسية المغزلي للإلكترونات، وهذا يوافق التركيب الإلكتروني للذرات العناصر التي لها صفات فيرو-مغناطيسية.



شكل (11-18): تجارب عن طبيعة الفيرومفناطيسية. تجربة أينشتين - ديهاس (a)، تجربة بارنيت (b) وتجربة إيف وكابيتزا (c).

و بما أن العزوم المغناطيسية للمدارات المغلقة تساوى صفرًا، وأن الإلكترونات التكافؤ الخارجية للذرات تتجمع (collectivized) في عملية تكوين المعدن، فإن الفيرومفناطيسية لابد أن تكون خاصية للعناصر الانتقالية فقط، لأن المدارات الداخلية فيها غير مكتملة. هذه العناصر تشتمل على المعادن الانتقالية لمجموعة الحديد التي فيها $3d$ غير مكتمل والعناصر الأرضية النادرة والتي فيها $4f$ غير مكتمل، ومن جهة أخرى، بما أن العزوم المغناطيسية المدارية للإلكترونات المدار $3d$ معطلة، وبالتالي تكون مشاركتها في الخواص المغناطيسية مهملة، لذلك ترجع الفيرومفناطيسية لعناصر هذه المجموعات إلى العزوم المغزليه الذريه فقط، وهي في هذه الحالة كبيرة جداً (أنظر جدول 11-3). هذا الافتراض طرح أولاً بواسطة العالم روزنج (B.Rozing) عام 1892، وأخيراً افترض العالم بيرووايس (Pierre Weiss) أنه يوجد مجال جزيئي قوي H في المادة الفيرومفناطيسية يتناسب مع قيمة التمagnetisية التشيعية J_s .

$$i.e \quad H = \eta J_s \quad (11-66)$$

و سميت η بثابت المجال الجزيئي. هذا المجال هو المسئول عن التمagnetis المترافق أو الذاتي للمواد الفيرومفناطيسية. وبإدخال المجال الجزيئي أصبح ممكناً تفسير الظواهر التي يمكن ملاحظتها في المواد الفيرومفناطيسية على مدى واسع. إلا أن طبيعة المجال نفسه ظلت سراً غامضاً حتى وقت طويل. في البداية، افترض أن أصل القوى التي توجه

العزوم المغزلي هو قوى مغناطيسية تظهر نتيجة للتفاعل بين العزوم المغناطيسية المغزلي spin-sing interaction، إلا أن الحسابات النظرية بينت أن طاقة هذا التفاعل U في حدود $J^{23} 10$ ، وهي أقل تقريباً برتبتين من الطاقة الحرارية (عند درجة حرارة الغرفة) التي تعمل على تعطيل انتظام الترتيب المغزلي. هذا يعني أن التفاعل المغناطيسي المغزلي غير قادر على القيام بالتوجيه الموحد للمواد الفيرو-مغناطيسية عند درجة حرارة أقل من نقطة كوري، وبالتالي فإن أصل المجال الجزيئي الذي يمكنه القيام بهذا التوجيه لا بد أنه غير مغناطيسي، وإنما يجب أن يكون راجعاً لتأثير أقوى مثل تفاعل التبادل الإلكتروني.

دور التفاعل التبادلي

في عام 1928 افترض فرنكل أن القوى المسئولة عن التوجيه التبادلي mutual Orientation للعزوم المغناطيسية الذرية هي قوى كهرومغناطيسية، حيث تكون ناتجة عن تفاعل التبادل الإلكترونيات المدارات الذرية الداخلية غير المكتملة.

ويشمل التفاعل التبادلي كل التفاعلات الكهرومغناطيسية (طاقة كولوم) بين النويات، الإلكترونات، الإلكترونات مع النويات، النويات مع الإلكترونات، ومحصلة هذه التفاعلات يعبر عنها بما يسمى تكامل التبادل أو تفاعل التبادل (J). وقيمة هذا التفاعل الكهرومغناطيكي تكون موجبة بين الشحنات المشابهة و سالبة بين الشحنات المختلفة. لذلك فإن إشارة تكامل التبادل J يمكن أن تكون موجبة أو سالبة طبقاً للعلاقة بين أبعاد المدارات الإلكترونية المشاركة في رابطة التبادل والمسافة بين الذرات، الأمر الذي يتسبب في تغيير طاقة النظام.

ولقد وجد أن الطاقة الحرة للنظام تكون أقل ما يمكن، وبالتالي يكون النظام مستقراً في الحالتين التاليتين:

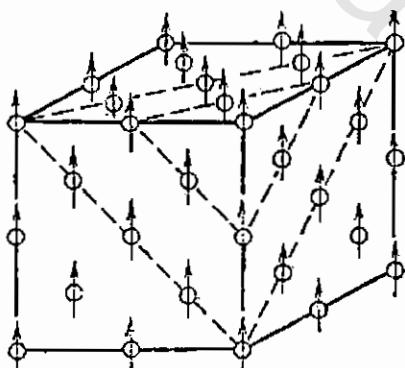
أ) عندما تكون إشارة تكامل التبادل سالبة ($J < 0$) والعزمان المغزليان للإلكترونيين المشاركين في رابطة التبادل متضادين الاتجاه $\uparrow \downarrow$.

وهذه الحالة كما نعلم خاصة بتكون الرابطة الكيميائية بين الذرات لتكوين الجزيء، وكما سنرى فيما بعد، فإن هذا هو الشرط الضروري للأنتيفيرو-مغناطيسية.

ب) عندما تكون إشارة تكامل التبادل موجبة ($J > 0$)، والعزمان المغزليان في اتجاه واحد $\uparrow \uparrow$. في هذه الحالة يكون التوجيه الموحد للعزوم المغزلي للذرات المتجاورة

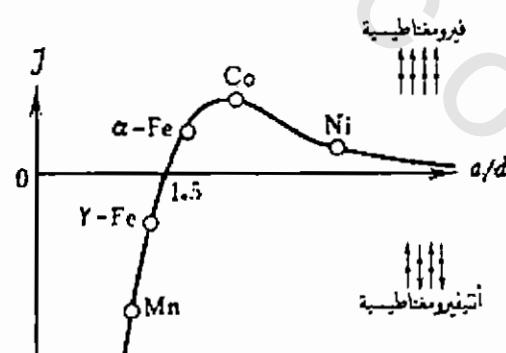
ملائماً من الناحية الطاقية. وهذا هو الشرط الضروري للفيرومغناطيسية، لأن التنظيم موحد الاتجاه للعزوم المغزلي وبالناتي للعزوم المغناطيسية يسبب تمغطاً ذاتياً، وهذا من صميم خصائص المواد الفيرومغناطيسية (شكل 19-11).

شكل (19-11) يبين اعتماد تكامل التبادل (طاقة التبادل) J على النسبة $\frac{a}{d}$ حيث a هي ثابت الشبكية، d = قطر الدار (3d) لذرات من مجموعة المعادن الانتقالية (مجموعة الحديد)، حيث يتضح من الشكل أنه إذا كانت $1.5 > \frac{a}{d}$ فإن J موجب والعكس بالعكس. كما يتضح أيضاً أن من بين العناصر الانتقالية يكون كل من الحديد، الكوبالت، النيكل فقط عبارة عن مواد فيرومغناطيسية. بينما المنجنيز وعناصر أخرى من هذه المجموعة التي لها $1.5 < \frac{a}{d}$ ليست مواداً فيرومغناطيسية. ولقد تبيّن من التجربة أنه بإدخال كمية من النيتروجين إلى شبكة المنجنيز، فإن ثابت الشبكية يزداد ويؤدي ذلك إلى ظهور الخصائص الفيرومغناطيسية. تظهر الخصائص الفيرومغناطيسية أيضاً في السبائك $Al\text{-Mn-Cu}$ وبعض المركبات مثل $MnSb$ & $MnBi$ التي فيها المسافات بين ذرات المنجنيز أكبر منها في حالة بلورات المنجنيز الندية.



شكل(19-11): التنظيم موحد الاتجاه للعزوم في المواد الفيرومغناطيسية

شكل (19-20): اعتماد طاقة التبادل على النسبة حيث ثابت الشبكية، d قطر الدار



- ومن ثم : فإن الشروط الضرورية للفيرو מגناطيسيية هي :

 - وجود مدارات ذرية داخلية غير مكتملة حتى تتوفر مدارات خالية تسمح بالحركة المغزليّة ، وهو مالا يتحقق لإلكترونات القلب الداخليّة.
 - أن تكون إشارة التكامل التبادلي موجبة حتى تؤدي إلى توجيه تلقائي موحد للعزوم المغزليّة ، وهذا يتطلب أن تكون كثافة الحالات في المنطقة كبيرة بحيث تجعل الطاقة الازمة للإصطدام المغزلي صغيرة ، وهو مالا يتحقق لإلكترونات التكافؤ لأن كثافة المدارات في منطقة التكافؤ عادة صغيرة.
 - أن تكون المسافة بين الذرات كبيرة نسبيا ($a > \frac{d}{b}$) حتى يمكن لقوّة التبادل جعل الحركة المغزليّة لإلكترونات المنطقة - d في الذرة قادرة على الإصطدام مع الحركات المغزليّة للذرات المجاورة ، الأمر الذي يتحقق للعناصر Co, Ni, Fe، فقط من بين العناصر الانتقالية ، ويتحقق كذلك للعناصر الأرضية النادرة التي تتميز بأغلفة داخلية مليئة جزئيا ، وكثافة المدارات بها كبيرة وبالتالي فهي مواد فيرو مغناطيسيّة.

العناصر الانتقالية

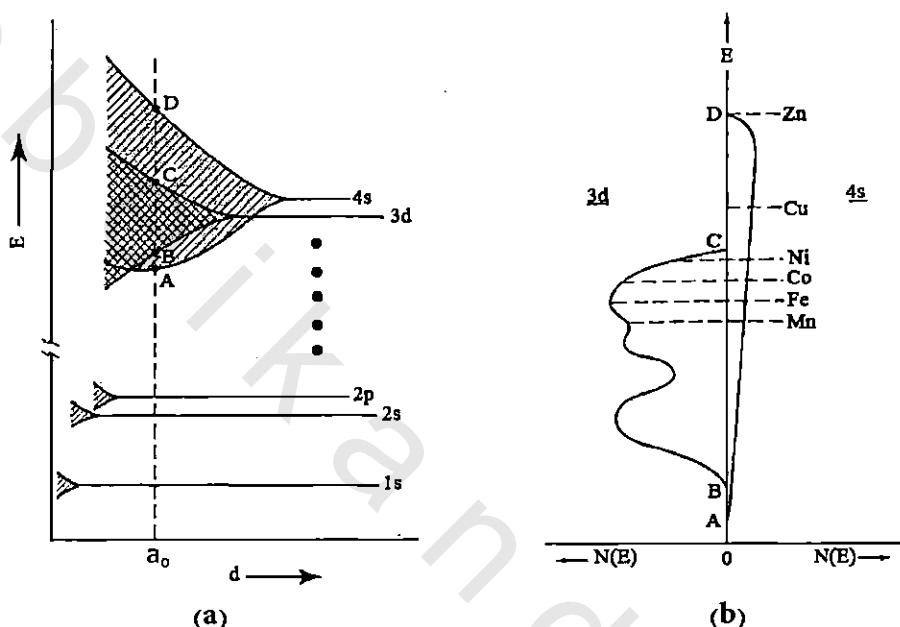
جدول (4-11) يبين التوزيع الإلكتروني في المدارين $4s$ ، $3d$ في الذرة الحرة لبعض العناصر التي تشمل العناصر الانتقالية، والتي بها المدارات الداخلية $3s$ ، $3p$ ، $2s$ ، $2p$ ، $1s$ ، ممثلة تماماً حيث يشغلها 18 إلكتروناً.

جدول (4-11): التوزيع الإلكتروني، في المدارين $4s$ ، $3d$ ، الذرة الحرة لبعض العناصر

		العناصر الانتقالية										
عدد الإلكترونات الغلاف	K Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	
3d	0 0	1	2	3	5	5	6	7	8	10	10	
4s	1 2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	
3d + 4s	1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

في الجسم الصلب تنبع هذه المدارات في مستويات طاقية (شكل 11-21.a)، حيث تتدخل المقطتان $4s$ ، $3d$ ، مما يعني أن طاقتيهما متساويتان تقريباً، كما تمتد المنطة في المدى $A-D$ الأوسع منه للمنطقة $3d$ التي تمتد في المدى $B-C$ الأضيق نسبياً، $4s$

وهو ما يعني أن كثافة الحالات بالمنطقة d كبيرة نسبياً. شكل (b-21) يعطى كثافة الحالات للمنطقتين $4s$ ، $3d$ ، والذى سوف نستخدمه لمناقشة التركيب الإلكتروني للعناصر من Mn حتى Zn ، وذلك مع افتراض أن شكل المناطق لا يتغير كثيراً من عنصر لآخر. خلال هذا المدى.



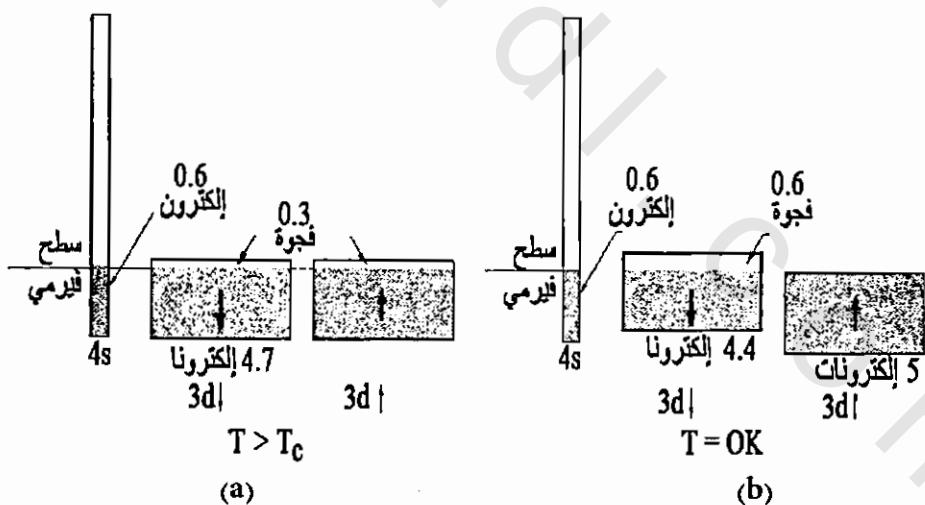
شكل : (11-21) تداخل المنطقتين الطيفيتين $4s$ ، $3d$ للعناصر الانتقالية (a)، وكثافة الحالات بهما (b)

المستوى $3d$ يمكن امتلاؤه كلها بعشرة إلكترونات، إلا أنه في العناصر الانتقالية لم يحدث هذا الإمتلاء الكامل. الخطوط المنقطة (شكل) تمثل مستوى فيرمي للعنصر المقابل، كما تبين إمتلاء المستوى $4s$ بإلكترونين، وحيث أن المستويين $4s$ ، $3d$ متداخلين فإنهما لابد أن يمتلئا إلى ارتفاع واحد (مثل الأوانى المستطرقة)، ويكون معيار امتلاء هذين المستويين معتمدا على عدد الإلكترونات الحالات $3d + 4s$ ، ولذلك يكون دائماً هذان المستويان في العناصر الانتقالية ممتلئين جزئياً.

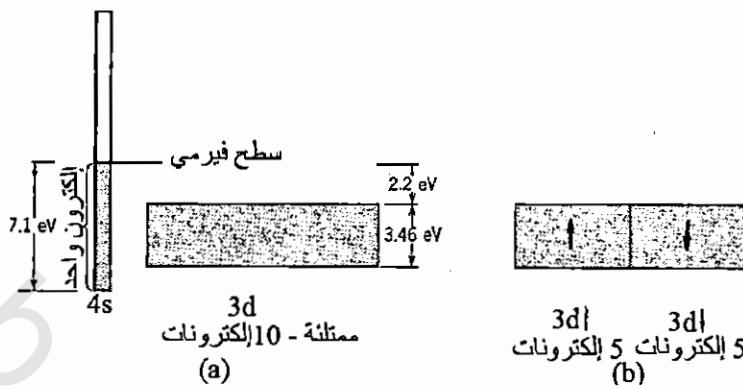
في النيكل يوجد عشرة إلكترونات في الحالات $4s + 3d$ تتوزع في الجسم الصلب بحيث 9.4 منها للمستوى $3d$ ، 0.6 منها للمستوى $4s$ (التوزيع المقابل في الذرة الحرة هو 8، 2 على التوالي)، حيث يقع مستوى فيرمي للنيكل تحت قمة المنطقة $3d$

مباشرة. شكل (11-22.a) يبين علاقة المناطق في النيكل فوق درجة حرارة كوري. محصلة العزم المغناطيسي تساوى صفرًا بسبب تساوى عدد الفراغات holes في المنطقتين \uparrow 3d، \downarrow 3d. وشكل (11-22.b) يبين علاقة المناطق في النيكل عند درجة الصفر المطلق. طاقات المنطقتين الفرعيتين \uparrow 3d، \downarrow 3d موزعة بواسطة قوة تفاعل التبادل، المنطقة \uparrow 3d مملوءة كلياً والمنطقة \downarrow 3d تحتوى على 4.4 إلكتروناً وعلى 0.6 فجوة. أما المنطقة 4s فإنها تحتوى على عدد متساوٍ من الإلكترونات ذات اتجاهى الحركة المغزلي. العزم المغناطيسي المحصل يساوى μ_B لكل ذرة، وينشأ من زيادة الإسكان في المنطقة \uparrow 3d بالنسبة للمنطقة \downarrow 3d. ويكون ممكناً القول أن التمغnet ناشئٌ من فجوة في المنطقة \downarrow 3d.

شكل (11-23.a) يعطى العلاقة بين المناطق 4s، 3d في معدن النحاس. تمتلىء المنطقة 3d في ذرة النحاس بعشرة إلكترونات، وتحتوى المنطقة 4s على إلكترون واحد (إلكترون تكافؤ) وهى بذلك نصف ممتلئة. شكل (11-23.b) يعطى نصف المنطقة 3d في النحاس، وهو عبارة عن منطقتين فرعيتين اتجاهات الحركة المغزلي فيها متضادة، وكل منطقة ممتلئة بخمسة إلكترونات، لذلك تكون المحصلة المغزليه وبالتالي محصلة التمغnet للمنطقة 3d تساوى صفرًا. يتضح من ذلك أن النحاس ليس مادة فيرومغناطيسية.



شكل (11-22): علاقة المناطق في النيكل فوق درجة حرارة كوري (a) وعنده درجة الصفر المطلق (b)

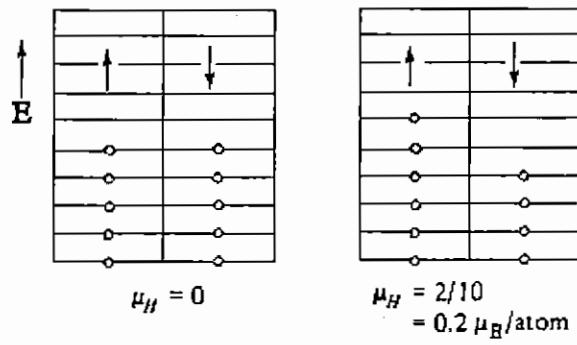


شكل (11 - 23): العلاقة بين المقطفين s ، $4s$ ، $3d$ للنحاس

في الزنك المنقطان $4s$ ، $3d$ مماثلتان كلاهما. وكما ذكرنا من قبل، فإن المدار الطاقية المغلقة لا تساهم في العزم المغناطيسي بسبب تضاد الحركة المغزليّة في المدار والتي تلغى بعضها بعضاً، وبالتالي يعتبر الزنك مادة غير فiero-مغناطيسية أيضاً.

ولحصول على صيغة تقريبية عامة للعناصر الفيرومغناطيسية دعنا نعتبر المثال التوضيحي المبين في شكل (24.a) لعشر ذرات حرة، كل ذرة منها تمتلك إلكترونا واحداً في مدار طاقى معين. إذا قربت هذه الذرات لتكوين البلورة، فإن المدار سوف ينقسم إلى عشرة مدارات، حيث يمتلك كل مدار من المدارات الخمسة السفلى إلكترونين، فإذا عكس أحد هذه الإلكترونات اتجاه حركته المغزلي كما في شكل (24.b)، فإن عدم التعادل المغزلي (spin imbalance) الناتج يساوى، ويكون العزم المغناطيسي للذرة هو:

$$\mu_H = 2/10 = 0.2 \text{ } \mu_B/\text{atom}$$



شكل (11-24): مثال توضيحي
للسنن ذات حرة واتجاه الحركة
المغزلية للكتروناناتها

والتأثير الذى سبب عدم التعادل المغزلى فى المادة الفيرومغناطيسية هو قوة التفاعل التبادلى (هذه القوة تتشبه فى مثال الأواني السابق السد الذى يحجز الماء فى نصف الآنية لمستوى أعلى منه للنصف الآخر).

وتعزى الفيرومغناطيسية لكل من Fe، Co، Ni إلى عدم التعادل المغزلى فى المنطقة 3d. إلكترونات المنطقة 4s لا تشارك فى المغناطيسية لأنها لا تخافض كثافة المدارات (الحالات) بها، وبالتالي تكون المدارات على مسافات واسعة من بعضها البعض. وبما أن المنطقة 3d تحتوى على 5 إلكترونات لها حركة مغزليه \uparrow ، 5 إلكترونات بحركة \downarrow ، فإن أقصى قيمة لعدم التعادل المغزلى (أى قيمة تمغنت التشبع) تتحقق عندما يمتلىء أحد نصفي المنطقة بخمسة إلكترونات. لنفرض أن :

$$n = \text{عدد إلكترونات } (3d + 4s) / \text{ ذرة.}$$

$$x = \text{عدد إلكترونات } 4s / \text{ ذرة.}$$

$$\therefore (n - x) = \text{عدد إلكترونات } 3d / \text{ ذرة.}$$

وعند التشبع، فإن الإلكترونات الخمسة للمنطقة 3d تمتلك حركة مغزليه \uparrow ، ويكون $5 - (n - x)$ إلكتروناً تملك حركة مغزليه \downarrow . لذلك، يكون العزم المغناطيسى لكل ذرة هو:

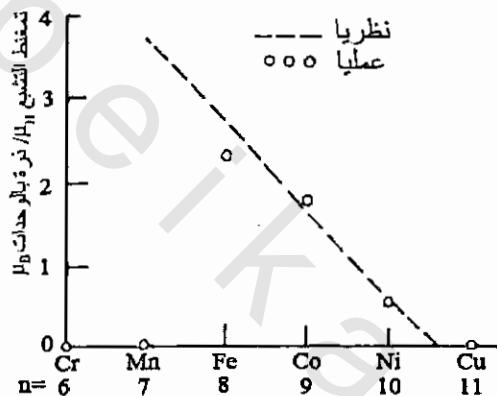
$$\begin{aligned} \mu_H &= \{5 - [(n - x) - 5]\}\mu_B \\ &= [10 - (n - x)]\mu_B \end{aligned}$$

واضح أن الفرق $[5 - (n - x) - 10]$ يساوى عدد الحالات الخالية فى المنطقة 3d (عدد الفجوات). باستخدام القيمة العملية للعزم الذرى $\mu_B = 0.6 \mu_H$ للنيكل فى العلاقة السابقة، نجد أن $0.6 = x$. هذا العدد يتناسب مع المساحة المحددة بالجزء السفلى لمنحنى كثافة الحالات للمنطقة 4s والخط المتقطع Ni (شكل 21-11). لذلك يمكن القول (كتقريب بسيط) أن عدد إلكترونات المنطقة 4s يساوى 0.6 كقيمة ثابتة لكل العناصر القريبة من النيكل، وبالتالي يكون:

$$\mu_H = (10.6 - n)\mu_B \quad (11-67)$$

القيم المحسوبة للعزم المغناطيسى / ذرة بواسطة هذه المعادلة بالمقارنة مع القيم التجريبية موضحة فى شكل (11-25) وجدول (11-5). القيمة السالبة للعزم فى حالة النحاس ليس لها معنى فيزيائى وذلك لأن المنطقة 3d للنحاس مشغولة تماما.

كما يظهر شكل (11 - 25) توافقاً جيداً بين القيم النظرية والعملية في حالات Fe, Co, Ni، ويتبين من القيم النظرية أن المنجنيز والعناصر الخفيفة التي تسبقه هي أكثر مغناطيسية من الحديد رغم أنها ليست مغناطيسية على الإطلاق. وطبقاً للمعادلة السابقة يكون للحديد خمسة إلكترونات ذات حركة مغزلية ↑، 2.4 إلكترون ذات حركة ↓، مما يؤدي إلى عدم تعادل مغزلي قيمته 2.6. أي أكبر بنسبة 20% تقريباً من القيمة المشاهدة عملياً.



شكل (11 - 25) : علاقة العزم المغناطيسي لكل ذرة بمجموع إلكترونات المدارين 3d, 4s لبعض العناصر.

جدول (11 - 52) : القيم العملية والنظرية للعزم المغناطيسي / ذرة لبعض العناصر

العنصر Element	Mn	Fe	Co	Ni	Cu
n	7	8	9	10	11
عملية μ_B/atom	0	2.22	1.72	0.6	0
نظرياً μ_B/atom	3.6	2.6	1.6	0.6	-0.4

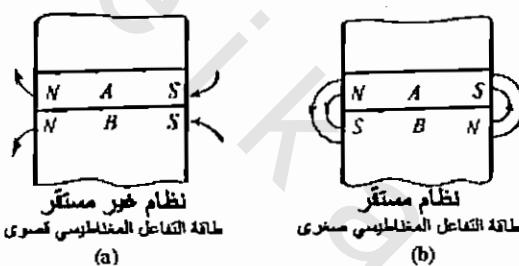
ووجود قيم كأعداد ليست صحيحة يرجع إلى أن الإلكترونات ذات العدد الصحيح في المدارين 3d, 4s في حالة الذرة تتوزع في الجسم الصلب بحيث ينتج غالباً أعداد غير صحيحة لإلكترونات المنشقتين 3d, 4s (راجع على سبيل المثال حالة النيكل) وبالتالي فإن عدد الإلكترونات غير المتزاوجة (الذى يعبر عن عدم التعادل المغزلي) في المنطقة 3d يكون أيضاً عدداً غير صحيح. وعليه تكون قيمة العزم μ_B ليست أعداداً صحيحة.

تركيب المنطقة Domain structure

في غياب المجال الخارجي فإن البللورة الفيرومغناطيسية تتكون من عدد كبير

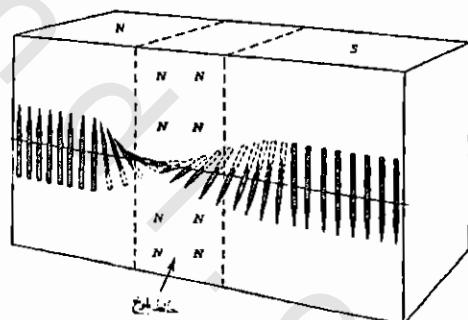
من المناطق الصغيرة المنفصلة والمغنة حتى التشبع. ولقد تبين أنه لكي يكون النظام مستقراً، لابد أن يكون التمغنط للمناطق المجاورة متعاكساً، حيث تكون طاقة التفاعل المغناطيسي أقل ما يمكن (شكل 26-11). هذه المناطق سميت مناطق التمغنط الذاتي domains، حيث تنفصل عن بعضها بطبقات يتغير فيها التوجّه المغزلي إلى العكس. هذه الطبقات الانتقالية بين مناطق التمغنط الذاتي تعرف بحوائط بلوك block walls (شكل 27-11). ولقد وجد أن سماكة هذه الحوائط في الحديد يساوي 300 ملليمتر تقريباً من ثابت الشبكة (أي في حدود 1000 \AA).

(شكل 28-11) يعطى صورة فوتونغرافية لتركيب مناطق التمغنط الذاتي في جانب من بلورة سيليكون فيرمونغناطيسي حيث تبيّن الأسماء اتجاهات التمغنط الذاتي في المناطق المجاورة.



شكل (26-11): تعاكس التمغنط
لمناطق المجاورة يجعل النظام مستقراً

شكل (27-11): مناطق التمغنط الذاتي
block walls وحوائط بلوك



شكل (28-11): صورة فوتونغرافية
لمناطق التمغنط الذاتي في بلورة
سيليكون فيرمونغناطيسي

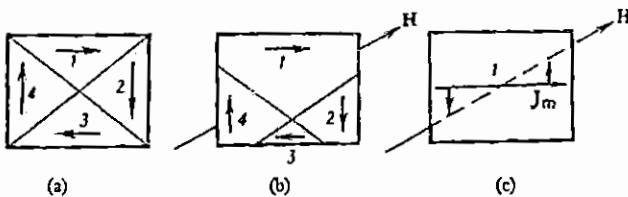


التحليل الكيفي لمنحنى التمغناط

في غياب المجال الخارجي يكون العزم المغناطيسي الكلي للمادة الفيرومغناطيسية مساويا الصفر (شكل 29.11) بسبب التوجهات التبادلية المتضادة لعزوم المناطق والتي تكون الطاقة الحرة للنظام عندها أقل ما يمكن. وعندما يطبق مجال خارجي H ، فإن المادة الفيرومغناطيسية تمغناط مكتسبة عزماً مغناطيسياً لا يساوي الصفر. وطبقاً للظواهر الفيزيائية التي تحدث في أثناء تمغناط المادة الفيرومغناطيسية فإن عملية التمغناط هذه يمكن تقسيمتها إلى ثلاثة مراحل:

1- مرحلة إزاحة حدود المناطق

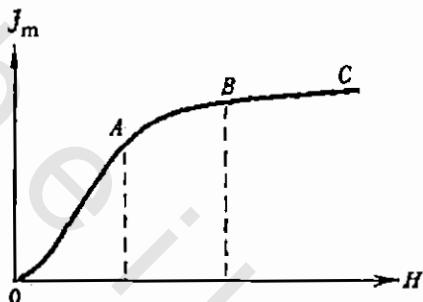
كما يتضح من شكل (29.11) فإن متجهات التمغناط (كما تشير الأسهم) تختلف من منطقة لأخرى (شكل 29.a)، وتتغير قيمة الزاوية بين هذه المتجهات واتجاه المجال الخارجي المغناط وتكون أصغر زاوية بين اتجاهي المجال ومتوجه التمغناط هي الخاصة بالمنطقة 1، في حين أكبر الزوايا تكون في حالة المنطقة 3. لذلك، فأسهل المناطق (من الناحية الطاقية) مسيرة للمجال هي المنطقة 1 حيث تكون عملية توجيه عزمه المغناطيسي في اتجاه المجال هي الأسهل. وعندما يزداد المجال H يكون ملائماً من الناحية الطاقية أن تنمو المنطقة 1 على حساب المناطق الثلاثة (شكل 29.b)، حيث تزاح حدود المناطق، ولهذا السبب فإن المرحلة الأولى لتمغناط العينة تعرف بعملية أو مرحلة الإزاحة (displacement process)، وتستمر هذه المرحلة حتى تنتشر المنطقة الأولى لتملا كل البلورة. ويمثل هذه المرحلة الجزء OA على منحنى التمغناط المبين بشكل (29.11). عند القيم الصغيرة للمجال H فإن التمغناط يزداد تدريجياً ويكون قابل للرجوع (reversible). في المجالات القوية يكون التمغناط على هيئة قفازات ويكون غير عكسي (غير قابل للرجوع irreversible – وهو ما يعرف بتأثير بارهاوسن (Barkhausen effect).



شكل (29.11): مراحل
تمغناط البلورة

٢- مرحلة الدوران Rotation

عندما يزداد H أكثر فإن متجه التمغناط الذاتي J_m يبدأ في الدوران ليأخذ اتجاه H شكل (c-29). ويزداد التمغناط بمعدل أبطأ من المرحلة الأولى وينتهي عندما ينطبق J_m على H . ويصل التمغناط في نهاية هذه المرحلة إلى التشبع التكنيكى (Technical saturation) ويمثل بالجزء AB على منحنى التمغناط.



شكل (11-30): النحنى $J_m - H$
ومراحل التمغناط

٣- مرحلة البارا para process

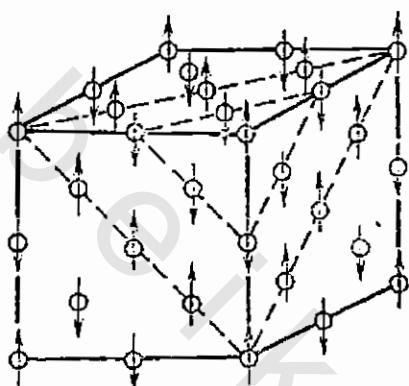
بعد الوصول إلى مرحلة التشبع التكنيكى فإن التمغناط يستمر في الزيادة مع زيادة المجال ولكن بمعدل أقل. والسبب في ذلك أنه عند أي درجة حرارة أعلى من الصفر المطلق لا تكون العزوم المغزلية كلها موحدة الاتجاه بسبب الحركة الحرارية. ويقوم المجال المغناطيسي القوى بإعادة توجيه هذه العزوم لتصبح موازية للعزوم الأخرى وفي اتجاه المجال، هذه المرحلة تمثل بالجزء BC على منحنى التمغناط.

الأنتيفير ومغناطيسية

علمنا أنه عندما يكون تكامل التبادل سالباً فإن التوجه المفضل للعزوم المغزلية لعقد الشبكية البلورية يكون متعاكساً، وفي هذه الحالة فإن التنظيم المغزلي يمكن أن يكون منتظم (orderd)، ولكن لا يوجد تمغناط ذاتي لأن العزوم المغزلية لعقد البلورية المتجاوحة متعاكسة (antiparallel) حيث تلغى بعضها بعضها.

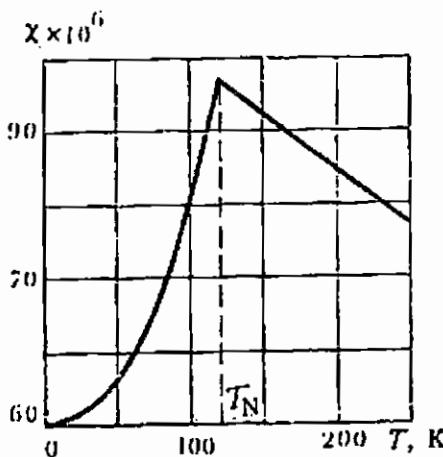
شكل (11-31) يبين التركيب المغناطيسي لأكسيد المنجنيز MnO ، حيث يمكن النظر إليه على أنه مكون من شبكتين فرعيتين ممغنطتين في اتجاهين متضادين. هذا التركيب يتواجد فقط تحت درجة حرارة معينة تسمى نقطة كوري curie point أو نقطة نبيل

Neel point لأنـيـفـيـرـوـمـغـناـطـيـسـيـةـ، وعـنـدـ درـجـةـ الصـفـرـ المـطـلـقـ فـإـنـ العـزـومـ المـغـناـطـيـسـيـةـ لـهـاتـيـنـ الشـبـكـيـتـيـنـ تـلاـشـىـ بـعـضـهـاـ وـيـكـونـ العـزـمـ المـغـناـطـيـسـيـ الـكـلـىـ صـفـراـ. وـبـارـفـاعـ درـجـةـ الـحرـارـةـ فـإـنـ التـرـتـيبـ الـمـتـعـاـكـسـ لـلـعـزـومـ الـمـغـزـلـيـةـ فـيـ الشـبـكـيـتـيـنـ يـتـشـوـهـ (disturbed) تـدـريـجـياـ، وـبـالـتـالـىـ تـزـادـ إـمـكـانـيـةـ تـمـغـنـطـ المـادـةـ الـأـنـيـفـيـرـوـمـغـناـطـيـسـيـةـ. وـيـصـلـ التـمـغـنـطـ إـلـىـ أـقـصـاهـ



شكل (11-31): التـرـكـيـبـ المـغـناـطـيـسـيـ لـأـكـسـيدـ الـنـجـنـيـزـ MnO

عـنـدـ درـجـةـ حرـارـةـ نـيـلـ Neel pointـ الـتـىـ عـنـدـهاـ يـتـلاـشـىـ تمامـاـ التـرـتـيبـ الـغـزـلـيـ المـنـظـمـ وـتـحـولـ المـادـةـ الـأـنـيـفـيـرـوـمـغـناـطـيـسـيـةـ إـلـىـ بـارـامـغـناـطـيـسـيـةـ. وـبـارـفـاعـ درـجـةـ الـحرـارـةـ فـإـنـ التـمـغـنـطـ يـقـلـ بـنـفـسـ الـطـرـيقـ الـتـىـ تـحـدـثـ فـيـ المـادـةـ الـبـارـامـغـناـطـيـسـيـةـ. شـكـلـ (11-32) يـبـيـنـ تـغـيـيرـ الـقـابـلـيـةـ المـغـناـطـيـسـيـةـ مـعـ درـجـةـ الـحرـارـةـ لـأـكـسـيدـ الـنـجـنـيـزـ الـذـىـ لـهـ $T_N = 120K$ ـ فـيـ مـجـالـ شـدـتـهـ $H = 4 \times 10^4 A/m$

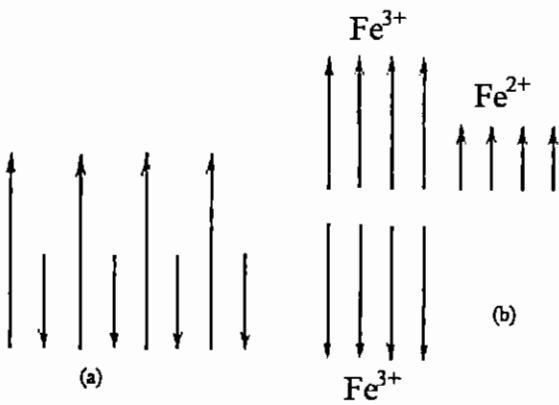


شكل (11-32): عـلـاقـةـ الـقـابـلـيـةـ المـغـناـطـيـسـيـةـ مـعـ درـجـةـ الـحرـارـةـ لـأـكـسـيدـ الـنـجـنـيـزـ

الفيريمغناطيسية (فيرايت Ferrites)

العزوم المغناطيسية للشبكيتين الفرعيتين في المادة الأنثيفرومغناطيسية تكون متساوية في المقدار ومتضادة في الاتجاه وينتج عن ذلك أن يلاشى كل منها الآخر تماماً. إلا أن هناك حالات تكون فيها قيمة العزوم المغناطيسية للشبكيات الفرعية ليست واحدة، وذلك بسبب الاختلاف في عدد الذرات أو في طبيعة الذرات التي تكون كل من الشبكيتين الفرعيتين (شكل 33.a). وهذا يؤدي إلى ظهور فرق محدد في العزوم المغناطيسية وظهور تمغنت ذاتي في البلاور. مثل هذه المواد الأنثيفرومغناطيسية غير التعويضية تسمى فيريمغناطيسية.

السلوك الخارجي للمادة الفيريمغناطيسية يكون مشابهاً لسلوك المادة الفيرومغناطيسية، ولكن بسبب الاختلاف في التركيب الداخلي فإن الاعتماد الحراري للتمغنت الذاتي فيهما يكون مختلفاً تماماً. فالتمغنت في المواد الفيريمغناطيسية ليس بالضرورة أن يقل مع ارتفاع درجة الحرارة ولكن يمكن أن يمر بالصفر حتى قبل الوصول لنقطة نبييل. ولنعتبر الماجنيتيت $\text{FeO} - \text{Fe}_2\text{O}_3$ كمثال للمادة الفيريمغناطيسية، حيث تكون أيونات الأكسجين السالبة شبكية من النوع FCC ويكون لكل جزء Fe_2O_3 آيون FeO - آيون Fe^{2+} وآيونان ثلاثية التكافؤ 2Fe^{3+} . الآيونات ثنائية التكافؤ يمكن أن يحل محلها آيونات ثنائية التكافؤ من معادن أخرى مثل Mg , Ni , Co , Mn , Cu , MeO -، وتكون الصيغة العامة لهذه الفئة والتي تعرف بالفيرايت (Ferrites) هي $\text{Fe}_2\text{O}_3 - \text{Me}$ حيث تمثل Me أيون المعدن ثنائية التكافؤ. إحدى الشبكات الفرعية تكون مكونة من نصف آيونات الحديد ثلاثية التكافؤ بينما الشبكة الفرعية الأخرى تكون مكونة من النصف الآخر بالإضافة إلى آيونات الحديد (أو العنصر البديل) ثنائية التكافؤ. وكما علمنا فالعزوم المغناطيسية للشبكيات الفرعية متعاكسة (antiparallel)، لذلك فإن العزوم المغناطيسية للأيونات ثنائية التكافؤ تلاشى بعضها ويكون التمغنت ناتجاً عن العزوم المغناطيسية لآيونات المعدن ثنائية التكافؤ (شكل 33.b).



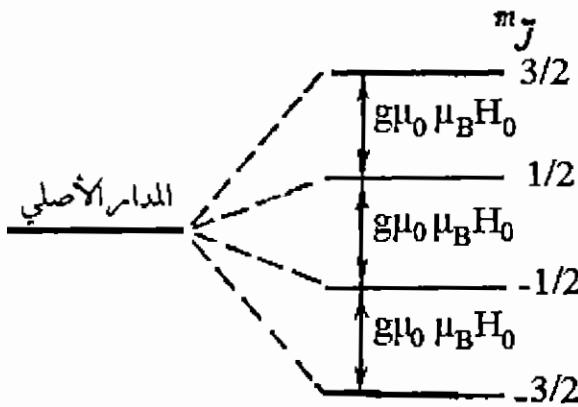
شكل(11-33): العزوم المغناطيسية فى المادة الفيريمغناطيسية (a)، والعزوم المغناطيسية للشبكيتين الفرعيتين (b)

كما ذكرنا من قبل، فإن المادة الفيراييت تتميز بعدد من البارامترات المغناطيسية الهامة (مثل النفاذية المغناطيسية العالية، وقوية المانعة الصغيرة، وتمغنت التشبع العالى....إلخ، بالإضافة إلى المقاومة الكهربائية العالية (فى حدود 10^3 ohm.m). هذه الخصائص يجعل الفيراييت قادرًا على عمل ثورة في مجال إلكترونيات الترددات العالية والعالية جدا. فمن المعروف أن المواد الفيرومغناطيسية العادية (10^{-3} ohm.m) لا يمكن استخدامها عند هذه الترددات بسبب فقد الطاقى نتيجة التيارات الدوامية. وبذلك فإن المواد الفيراييت تحتل المركز الأوحد في هذا المجال. والفيراييت ذو منحني تخلف مغناطيسى مستطيل الشكل، مما جعله يستخدم الآن بشكل واسع فى عناصر التخزين الرقمية فى الكمبيوتر.

الرنين المغناطيسى Magnetic resonance

كما علمنا، فإن العزم المغناطيسى للذرات التي بها عدد غير زوجى من الإلكترونات يمكن أن يوجه في اتجاه المجال المغناطيسى H_0 بعدد من الطرق المختلفة يساوى $(2J + 1)$ ، أي أن عدد المساقط المختلفة للعزم في اتجاه المجال يساوى $(2J + 1)$. وتعطى الطاقة المقابلة لكل من هذه المساقط بالعلاقة الآتية:

$$U_m = \mu_0 M_{JH} H_0 = m_J g \mu_0 \mu_B H_0 \quad (11 + 68)$$



شكل (11-34): انلاق المدار الطaci الذري تحت تأثير المجال المغناطيسي

لذلك فإن المدار الطaci الذري ينفلق في المجال المغناطيسي إلى $(1 + 2J)$ من المدارات الفرعية (شكل 11-34). وتكون المسافة الطaciية بينها ΔU_m هي:

$$\Delta U_m = g\mu_0\mu_B H_0 \quad (11 + 69)$$

في حالة الاتزان الحراري فإن الذرات تكون موزعة على هذه المدارات الفرعية تبعاً لقانون بولتزمان كالتالي:

$$n_1 = c \exp\left(-\frac{Jg\mu_0\mu_B H_0}{k_B T}\right) \quad \& \quad n_2 = c \exp\left(-\frac{(J-1)g\mu_0\mu_B H_0}{k_B T}\right)$$

حيث n_1, n_2 هما عدداً الذرات التي تشغّل المدار J & $m_J = J-1$ على $m_J = J$ والمدار $J=1$ على الترتيب، ولكن يحدث انتقال الذرات من المدار الفرعى الأدنى إلى الأعلى يلزم استخدام مجال كهرومغناطيسي خارجي، حيث تسمح قواعد الاختيار الطيفية فقط بالانتقالات التي تعطى تغييراً في العدد الكمى المغناطيسي مقداره الوحدة:

$$\text{i.e.} \quad \Delta m_J = \pm 1 \quad (11 + 70)$$

أى يسمح بتلك الانتقالات بين المستويات الفرعية المتجاورة التي يكون بينها فرق في الطاقة قدره $g\mu_0\mu_B H_0$ فقط. هذه الانتقالات يمكن إثارتها باستخدام مجال كهرومغناطيسي ذى طاقة $\hbar\omega$ تعطى كالتالي:

$$\hbar\omega = g\mu_0\mu_B H_0 \quad (11 - 71)$$

وعندما تتحقق العلاقة (11-71) يحدث الرنين ويكون امتصاص الطاقة الكهرومغناطيسية شديداً. وتسمى العلاقة (11-71) شرط الرنين البارامغناطيسي

الإلكترونى (EPR). ويكون التردد الرئيسي v_{res} دالة فى شدة المجال المغناطيسى الثابت H_0 ، حيث عندما $H_0 = 5.6 \times 10^5 \text{ A/m}$ فإن $v_{reson} = 2 \times 10^4 \text{ MHz}$ تقابل طولاً موجياً قدره $\lambda = 0.016 \text{ m}$.

وهناك ظاهرة مشابهه تسمى الرنين المغناطيسى النوى (NMR)، حيث يتأثر العزم المغناطيسى النوى بال المجال المغناطيسى الخارجى ويحدث انفلاق فى مستويات الطاقة داخل النواة، ويحدث الرنين النوى المغناطيسى عندما تتذبذب النواة بين مستويات الطاقة. والرنين النوى لمجال $H_0 = 5.6 \times 10^4 \text{ A/m}$ يوجد عند تردد $v_{reson} = 30 \text{ MHz}$ بطول موجى قدره $\lambda \approx 10 \text{ m}$.

قياس القابلية المغناطيسية والعزم المغناطيسى

أولاً قياس القابلية المغناطيسية

يوجد عدد من الطرق التى يمكن استخدامها لتعيين القابلية المغناطيسية، سنتناول بعضها باختصار فيما يلى.

١. طريقة فاراداي Faraday's method

هذه الطريقة تتناسب قياس القابلية المغناطيسية لعينات صغيرة من المواد الدايا- البارا- أو حتى الفيرومغناطيسية. فإذا وضعت العينة ذات الحجم V في مجال مغناطيسى متدرج شكل (11-35.a) وكانت معلقة فى قب ميزان، فإنه يحدث تغير فى وزنها بالزيادة نتيجة قوة الجذب إذا كانت المادة بارامغناطيسية، أو بالنقص إذا كانت المادة دايماغناطيسية. هذا التغير الظاهرى فى قوة وزن العينة df_y يتتناسب طردياً مع كل من تعمقية المادة J_m ، التدرج فى شدة المجال $\frac{dH}{dy}$ وكذلك مع حجم المادة dV الواقع تحت تأثير المجال المغناطيسى.

$$i.e \quad df_y \propto J_m \frac{dH}{dy} dV$$

$$\therefore df_y = \mu_0 \chi H \frac{dH}{dy} dV \quad (11 - 72)$$

$$\therefore f_y = \mu_0 \chi V H \frac{dH}{dy}$$

وفي هذه الطريقة تتعلق عينة صغيرة من المادة بين وجهين متشابهين لмагناطيس يصمم خصيصاً ليحافظ على $H = \text{constant}$ عبر العينة كما في شكل (11-35.a)، وهكذا يمكن تعريف χ .

٢. طريقة ميزان جوى Guoy's method

يستخدم مجال مغناطيسي متغير (شكل 11-35.b) بدلاً من المجال المدرج المستخدم في طريقة فارادى. المعادلة (11-72) يمكن إعادة كتابتها كالتالي:

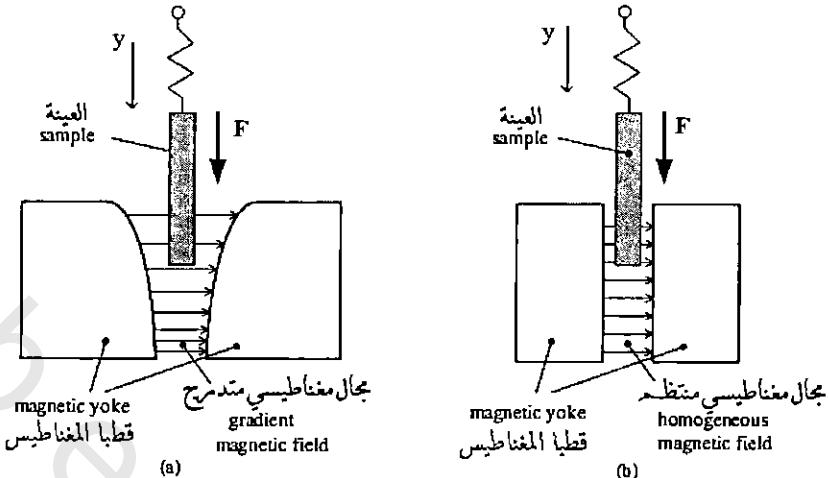
$$\begin{aligned} df_y &= \mu_0 \chi H \frac{dH}{dy} dx dy dz \\ &= \mu_0 \chi d\left(\frac{H^2}{2}\right) dx dz \\ &= \frac{1}{2} \mu_0 \chi d(H^2) A \end{aligned}$$

حيث $A = dxdz$ هي مساحة مقطع العينة. وتعطى القوة المحورية f المؤثرة على العينة في المجال المغناطيسي بإجراء التكامل من H_2 (المجال الضعيف) إلى H_1 (المجال القوى بين قطبي المغناطيس).

$$\begin{aligned} \therefore f &= \frac{1}{2} \mu_0 \chi A \int_{H_2}^{H_1} d(H^2) \\ &= \frac{1}{2} \mu_0 \chi A (H_1^2 - H_2^2) \end{aligned}$$

ويمكن إهمال H_2^2 بالنسبة لقيمة H_1^2 حيث أن H_1 أكبر من H_2 .

حيث f هو التغير في الوزن الظاهري للعينة، H هو شدة المجال بين قطبي المغناطيس.



شكل: (11-35) طريقتا فاراداي (a)، وميزان جوى (b) لقياس القابلية المغناطيسية

٣. طريقة إيفنس Evan's method

استطاع إيفنس عام 1974 من تطوير فكرة ميزان جوى وتحويله إلى جهاز خفيف الوزن، يعمل رقميا digital ولا يحتاج إلى مغناطيس منفصل ويستخدم للجوامد والسوائل والمحاليل ولا يحتاج لأوزان كبيرة (فقط في حدود 50 mg) من المادة.

في طريقة جوى يقوم الميزان بقياس التغير الظاهري في وزن العينة الناتج من مجموع قوتي التناور الدايمغناطيسي والتلاجدب البارامغناطيسي للمجال المطبق. ميزان إيفنس يستخدم نفس الفكرة، لكن بدلاً من قياس القوة التي يؤثر بها المغناطيس على العينة، يقوم بقياس القوة المضادة والمساوية (رد الفعل) الذي تؤثر به العينة على مغناطيس ثابت معلق وذلك بقياس التغير في التيار المطلوب للحفاظ على المغناطيسيات المعلقة في وضع الاتزان عندما يتفاعل المجال مع العينة. هذه المغناطيسيات تكون عند أحد طرفي شعاع الميزان حيث تقوم بتغيير موضع الشعاع عند التفاعل مع العينة. هذا التغير يسجل بواسطة الكواشف photo diodes الموضعة عند الطرف الآخر لشعاع الميزان، حيث تقوم بإصدار إشارة للمصدر amplifier الذي يقوم بدوره بتزويد الملف بالتيار اللازم لإعادة وضع الاتزان. وباستخدام فولتميتر لقياس الجهد على المقاومة المعلومة المتصلة على التوالى مع الملف يمكن تعين هذا التيار مباشرة، حيث تعطى قيمته رقميا على الجهاز.

وتحسب القابلية المغناطيسية الكتليلية χ_p في نظام الوحدات c.g.s من العلاقة الآتية:

$$\chi_p = \frac{CL(R-R_0)}{m \times 10^9} \quad (11 - 74)$$

L - طول العينة (cm)، m - كتلتها بالجرام، C - ثابت المعايرة للميزان، R،

R₀ - قراءة الجهاز في وجود وعدم وجود العينة على الترتيب.

٤. طريقة الحث

تعتمد هذه الطريقة على تغيير الحث المغناطيسي في الملف نتيجة وضع العينة داخله، حيث تستخدم قنطرة اتزان مكونة من ملفين متماثلين يستمدان تياريهما من مولد متعدد مستقر، ويوضع في أحدهما العينة ويؤخذ الآخر كمرجع (reference). وبمعرفة قيمة التغير في الحث B_1 يمكن إيجاد χ من العلاقة التالية:

$$\chi = \frac{B_1}{B_0} = \frac{B - B_0}{B_0} \quad (11 - 75)$$

$$B_1 = Im = \mu_0 J_m = \chi B_0$$

ثانياً حساب العزم المغناطيسي

- كما ذكرنا آنفاً فإن العزم المغناطيسي ينشأ من المشاركة المغزليّة والمدارية للإلكترونات غير المتزاوجة وجود الروابط coordinated ligands حول آيون المعدن يؤدي إلى تخميد المشاركة المدارية لتصبح المشاركة المغزليّة أعظم أهمية. لذلك بإهمال المشاركة المدارية، فإن قيمة العزم المغناطيسي يعطى بدلالة وحدة بوهر ماجنتون بالصورة التالية:

$$\mu_s = g\sqrt{S(S+1)} \quad (11 - 76)$$

بالتعويض عن: $S = n\left(\frac{1}{2}\right)$ ، $g = 2$ ، n هي عدد الإلكترونات غير المتزاوجة، نجد أن:

$$\mu_s = \sqrt{n(n+2)} \quad (11 - 77)$$

حيث تعطى العزم المغناطيسي المغزلي بدلالة عدد الإلكترونات غير المتزاوجة.

كما تعطى مركبة العزم μ_{sH} في اتجاه المجال بالعلاقة (11 - 43)، حيث:

$$\mu_{sH} = M_{JH} = g J \mu_B$$

وبالتعويض عن: $2 = S = n \left(\frac{1}{2}\right)$, $g = 2$, نجد أن:

$$\mu_{sH} = n ; \mu_B \quad (11 - 78)$$

أى أن قيمة العزم الذرى فى اتجاه المجال تساوى عددا من وحدات بوهر ماجنتون مساويا لعدد الإلكترونات غير المتزاوجة فى الذرة، وهو ما توصل إليه أوتوستيرن ووالثرجيرلاخ عمليا.

جدول (11-6) يعطى مقارنة لقيم، المحسوبة بالعادتين، مع القيم المقاسة عمليا بالبوهر ماجنتون لبعض الحالات :

جدول (11-11) : مقارنة بين قيم العزم المغناطيسي والقيم المقاسة عمليا.

الحالة	n	$s = n \left(\frac{1}{2}\right)$	μ_s, μ_B	μ_{eff}, μ_B	μ_{sH}, μ_B
Sc	1	$\frac{1}{2}$	1.73	1.7 - 2.2	1
Ti	2	1	2.83	2.8 - 4.0	2
V	3	$\frac{3}{2}$	3.87	3.8 - 5.2	3
Fe	4	2	4.90	5.1 - 5.5	4
Mn	5	$\frac{5}{2}$	5.92	~ 5.9	5

قيمة العزوم المغناطيسية الفعلية تبدو أكبر بعض الشئ منها للعزوم μ_s ، وقد يكون ذلك لأنه لم يؤخذ في الاعتبار المشاركة المدارية غير مكتملة التخميد، كما أن قيمة μ_s تكون عادة أكبر من قيمة μ_{sH} لأن الطاقة تكون أقل ما يمكن عندما يكون العزم فى اتجاه المجال المغناطيسي.

بتعبين القيمة التقريبية عمليا للعزوم المغناطيسي الفعال μ_{eff} , فإنه يمكن استخدامها كطريقة عملية لتعيين عدد الإلكترونات غير المتزاوجة فى المعادن الانتقالية، وهذا بدوره يزودنا بمعلومات عن الحالة المغزلية للمعدن وحالة الأكسدة وطريقة الترابط.

قياس العزم المغناطيسي

العزوم المغناطيسية لا تقايس مباشرة، وإنما تحسب من القابلية المغناطيسية المقاسة χ_{meas} كالتالى:

$$\chi_{\text{meas}} = \chi_{\text{para}} + \chi_{\text{dia}}$$

وبما أن χ_{para} أكبر قيمة من χ_{dia} من بعدة رتب ، فإن العزم المغناطيسي للمواد البارامغناطيسية يمكن حسابه (طبقاً لتصحيح باسكال) من العلاقة الآتية :

$$\mu_{\text{eff}} = 2.84(\chi_{\text{para}} T)^{\frac{1}{2}}, \quad \mu_B \quad (11-79)$$

- لحساب العزم المغناطيسي الكلي لمجال شدته 1 Am^{-1} من القابلية المغناطيسية تتبع الخطوات التالية :

١- إذا علمت القابلية الحجمية χ ، حيث :

$$M = J_m V = \chi H V$$

فقط نحتاج لعرفة حجم المادة V .

٢- إذا علمت القابلية الكتليلية χ_p ، حيث :

$$M = \chi H V = \rho \chi_p H V = \chi_p H m$$

نحتاج معرفة الكتلة m .

٣- أما إذا علمت القابلية المولارية χ_m ، حيث :

$$M = \chi H V = \frac{\rho \chi_m}{W_a} V H = \left(\frac{m}{W_a} \right) \chi_m H = n \chi_m H$$

حيث W_a هي الوزن الجزيئي (كتلة واحد مول) ، فإنه يلزم معرفة عدد المولات

$$\left(\frac{m}{W_a} \right)$$

